

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

جزوه خواص فیزیک ۲

استاد زهره بلک

فهرست

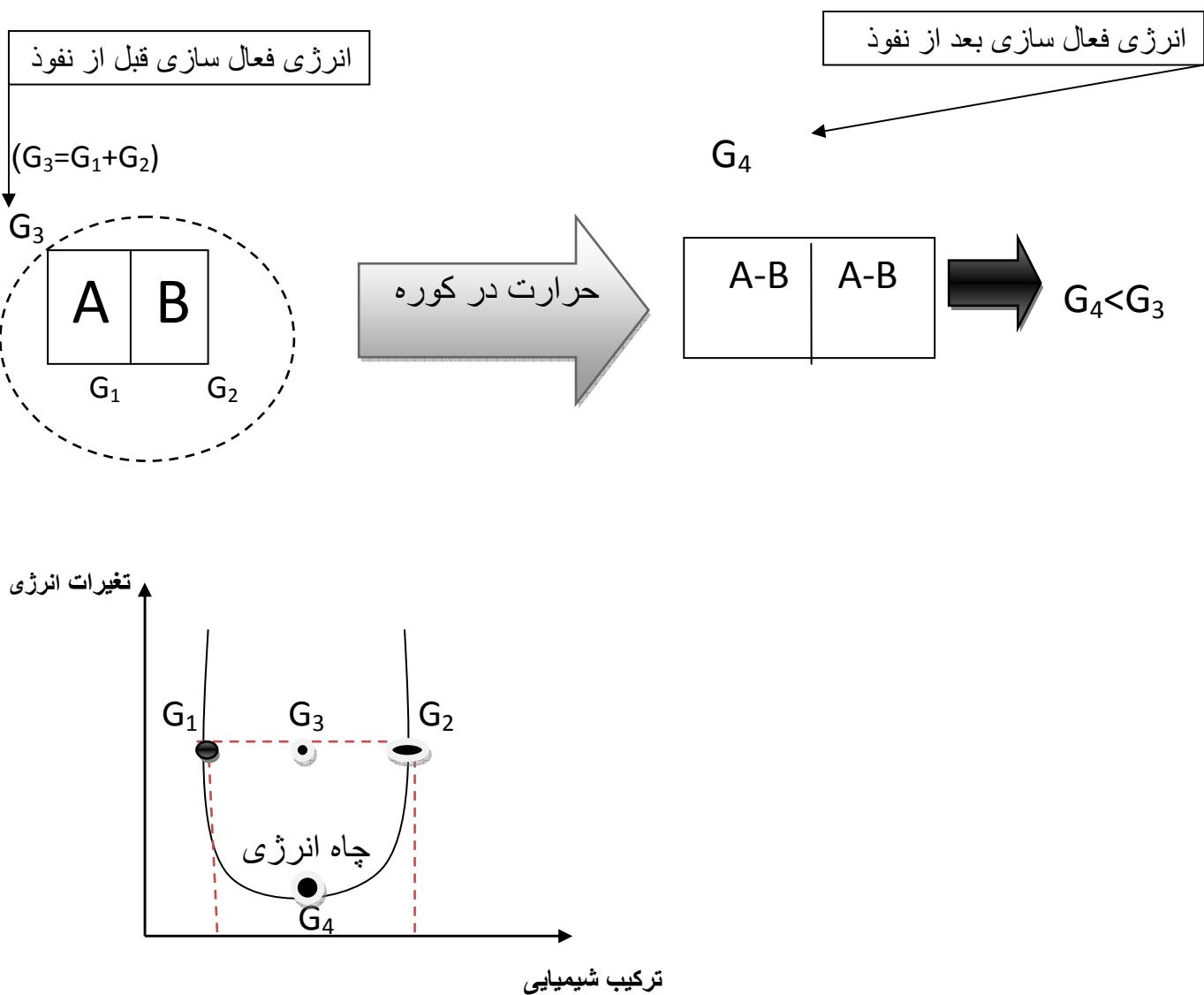
۳	مقدمه ای بر نفوذ
۴	mekanizm hāye nafud
۶	قانون اول فیک
۹	ضریب نفوذ
۱۰	قانون دوم فیک
۱۴	کاربردهای قانون دوم فیک
۱۴	مهندسی سطح
۱۷	همگن سازی
۱۸	نفوذ بین نشین
۱۹	نفوذ جانشین
۲۰	ضریب نفوذ در خود
۲۰	پدیده‌ی کرکندا
۲۰	تحلیل دارکن
۲۱	استحالة‌های فازی در حالت همگن
۲۴	انواع فصل مشترک ها
۲۵	تعادل فصل مشترک
۲۸	شکل رسوبات
۲۸	انواع استحالة‌ها (جامد - جامد)
۳۴	منابع

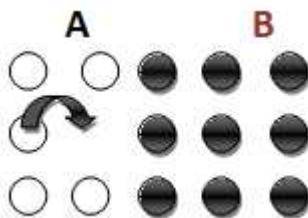
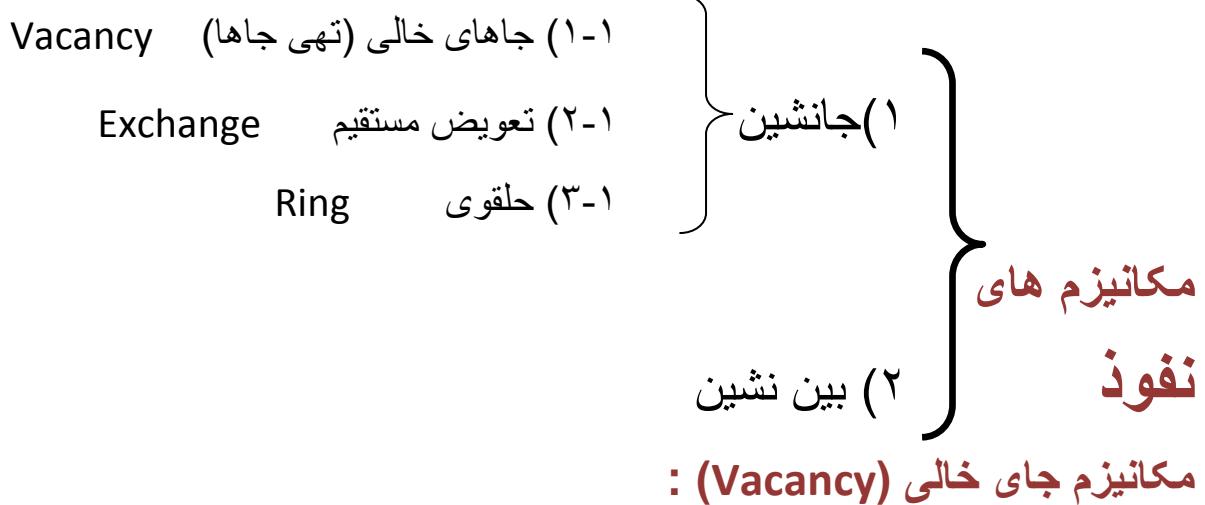
نفوذ (Diffusion)

به حرکت و جابجایی ماده در حالت های جامد ، مایع و گاز رخ می دهد . ارتعاشات اتمی و جاهای خالی (تهی جاها یا vacancy) به اتم ها اجازه ی جابجایی و حرکت می دهد . نفوذ نقش بسیار مهمی را در فرایندهای متالورژیکی ایفا می کنند به عنوان مثال برای بررسی فرآیندهایی نظیر استحالة ی فازی ، اتصال مواد و فلزات ، جوشکاری ، لحیم کاری، متالورژی سطح، همگن سازی ، متالورژی و پودر ، ذوب و ریخته گری و غیره باید اطلاعات کاملی پیرامون نفوذ داشته باشیم. انواع نفوذ عبارت است از : ۱) گاز در گاز ۲) مایع در مایع ۳) جامد در جامد

علت نفوذ :

دلیل وقوع نفوذ کاهش انرژی آزاد گیبس در سیستم است . در واقع رخداد نفوذ ناشی از وجود اختلاف غلظت یا اختلاف سطح انرژی بین بخش های مختلف یک ماده است ولی این نیرو محركه (اختلاف سطح انرژی) برای نفوذ کافی نیست و نیازمند انرژی فعال سازی (اکتیواسیون) می باشد . سرعت نفوذ به شدت تابع دماست . فلز A و B را در نظر بگیرید که به ترتیب دارای انرژی های G_1 و G_2 می باشند . انرژی کل سیستم برابر با G_3 بوده (قبل از نفوذ) که با اعمال حرارت و گذشت زمان به انرژی G_4 کاهش می یابد [علت کاهش انرژی این است که نفوذ در آن اتفاق افتاده است].





این مکانیزم شامل نفوذ یک اتم به جای خالی مجاور خود می باشد. این پدیده در ساختارهای کریستالی فشرده مانند FCC و HCP رخ می دهد زیرا انرژی حرکه‌ی لازم جهت نفوذ توسط جاهای خالی در این شبکه‌ها نسبت به سایر مکانیزم‌ها کمتر است در واقع این مکانیزم به عنوان غالب ترین و مهم‌ترین مکانیزم نفوذ است.

عوامل موثر بر سرعت مهاجرت اتم:

۱) غلظت جاهای خالی ۲) دما

نکته: هرچه دما بیشتر و غلظت جاهای خالی بیشتر باشد، سرعت بیشتر است.

۱) غلظت جاهای خالی :

غلظت جاهای خالی در m^3 فلز = $n \Omega$

تعداد کل موقعیت‌های اتمی در m^3 فلز = N

انرژی فعال سازی لازم جهت تشکیل یک جای خالی ($\frac{cal}{mol}$ یا $\frac{j}{mol}$) = Q

درجه حرارت بر حسب کلوین (0k) = ثابت بولتزمن 8.62×10^{-5}

ثابت گازها ($\frac{m^2}{s}$) = D ($R=1.987 \frac{cal}{mol.k}$ = $8.314 \frac{j}{mol.k}$) = ضریب نفوذ = R

انرژی فعالسازی لازم جهت تشکیل یک جای خالی (بر حسب الکترون ولت) = E

$$\frac{n_V}{N} = C \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right)$$

$$\frac{n_V}{N} = C \exp\left(\frac{-E_V}{KT}\right)$$

راه افزایش غلظت جاهای خالی در دما اتاق (دمای پایین) :

قطعه را تا دماهای بالا گرم نموده و سپس سریعاً آن را سرد می نماییم .

مثال) با توجه به اطلاعات داده شده مطلوب است :

(الف) تعداد جاهای خالی تعادلی (cu) (ب) کسر جاهای خالی تعادلی در مس (cu)

$$T = 500^{\circ}\text{C} \quad E\varphi = 0.9 \quad K = 8.62 \times 10^{-5} \left(\frac{eV}{K} \right) \quad \rho_{\text{Cu}} = 8.96 \times 10^6 \quad \frac{Mg}{m^3}$$

$$C=1 \quad M_{\text{Cu}} = 63.54 \text{ gr}$$

جواب : (الف)

$$\frac{n_V}{N} = C \exp \left(\frac{-E_V}{KT} \right) \rightarrow n = NC \exp \left(\frac{-E_V}{KT} \right) \rightarrow N = \frac{N_0 \rho_{\text{Cu}}}{M_{\text{Cu}}} = \frac{6.02 \times 10^{23} \times 8.96 \times 10^6}{63.54} =$$

$$N = 8.49 \times 10^{28} \quad \frac{\text{atom}}{m^3}$$

$$n_V = 8.49 \times 10^{28} \times 1 \times \exp \left(\frac{-0.9}{8.62 \times 10^{-5} \times 773} \right) = 1.2 \times 10^{23} \frac{\text{jahay-e-khalii}}{m^3}$$

: (ب)

$$\frac{n_V}{N} = 1 \exp \left(\frac{-0.9}{8.62 \times 10^{-5} \times 773} \right) = 1.4 \times 10^{-6}$$

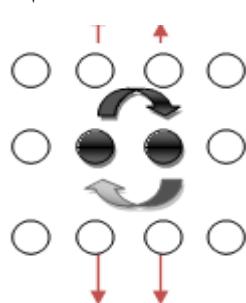
یعنی به ازای تقریباً هر یک میلیون اتم فقط یک جای خالی وجود دارد.

دما : (۲)

هر اتم در شبکه حول موقعیت خود در نوسان است بنابراین با افزایش درجه حرارت ، انرژی ارتعاشی نیز افزایش می یابد و از طرفی چون فرکانس ارتعاش ثابت است با زیاد شدن دما دامنه نوسان نیز افزایش می یابد تا جایی که منجر به جدا شدن آن از اتم های اطراف می شود و در صورت وجود یک جای خالی در مجاورتش ، به آن مکان پرس می کند.

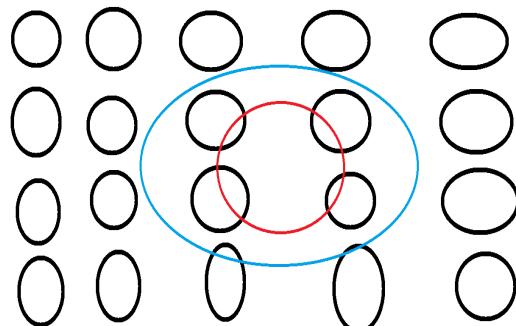
۲-۱) تعویض مستقیم (exchange)

این مکانیزم بیشتر در شبکه های اتمی با دانسیته کم (BCC) اتفاق می افتد . در این مکانیزم دو اتم مستقیماً جای خود را با هم عوض می کنند این امر نیازمند حرکت اتم های محاصره کننده ای جفت تعویضی به سمت خارج شبکه می باشد انرژی محرکه ای لازم برای این نوع جابجایی بسیار زیاد بوده و اتم ها در دماهای بالا و نزدیک به نقطه ذوب از این طریق جابجا می شوند . انرژی محرکه ای لازم برای اینکه نفوذ از طریق این مکانیزم رخ دهد نسبت به مکانیزم جای خالی بیشتر است.

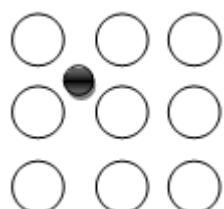


۳-۱) حلقوی یا زنجیری (Ring) :

در این روش چند اتم (بیش از ۳ اتم) با هم می چرخند. در اثر چرخش این اتم ها انبساط موضعی ایجاد می شود و انرژی داخلی سیستم بالا می رود که این انرژی همان انرژی حرکتی لازم برای نفوذ است . احتمال وقوع این مکانیزم نسبت به سایرین کمترین است. (در BCC احتمال وقوع این مکانیزم بیشتر از FCC و HCP است)



۲) بین نشین :

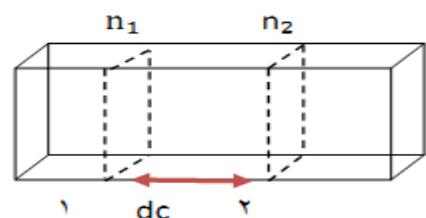


فضاهای خالی بین اتم های شبکه (اکتاھدرال ، تتراهرال) می توانند اتم های حل شونده ای که از نظر ابعاد و حوضه ای اعمال انرژی کوچکتر از اتم های شبکه هستند را در خود جای دهند. اگر قطر اتم نفوذ کننده (ناخالصی یا آلیاژی) کمتر از ۰.۶ قطر اتم زمینه باشند می توانند در صورت کسب انرژی حرکتی مورد نیاز، از بین اتم اصلی عبور کرده و در فضای خالی قرار می گیرند. این مکانیزم در سرامیک ها نیز رخ می دهد .

نکته : اتم های بین نشین دارای عدد همسایگی هستند .

خطی	متلثی	مکعبی	اکتاھدرال	تتراهرال	نوع شبکه
۲	۳	۸	۶	۴	عدد همسایگی

قانون اول فیک:



$\square =$ اتا = احتمال پرش اتم

احتمال پرش در راستای محور x : $\frac{1}{6} \square$

صفحه ۱) $n_1 = \frac{atm}{m^2}$ تعداد اتمی که از صفحه ۱ به ۲ می‌روند.

صفحه ۲) $n_2 = \frac{atm}{m^2}$ تعداد اتمی که از صفحه ۲ به ۱ می‌روند.

$\alpha =$ فاصله بین دو صفحه

$n = \frac{atm}{m^2}$ تعداد اتم در واحد سطح

$C = \frac{atm}{m^3}$ غلظت در واحد حجم

$$n_1 = C_1 \times \alpha \left(\frac{atm}{m^2} = \frac{atm}{m^3} \times m \right)$$

$$n_2 = C_2 \times \alpha$$

$$j = \frac{1}{6} (n_1 - n_2) \quad \text{شار یا فلو یا فلاسک}$$

$$j = \frac{1}{6} \alpha (C_1 - C_2)$$

رابطه شماره A

$$C_2 = C_1 + dC$$

رابطه B

اختلاف غلظت صفحه ۱ و ۲ = dc

با قرار دادن B در A خواهیم داشت:

$$J = \frac{1}{6} \alpha (C_1 - C_1 - dc) = \frac{-\alpha dc \times dx}{6 dx}$$

$$j = -\frac{\alpha^2}{6} \cdot \frac{dc}{dx}$$

$$j = -D \left(\frac{\partial c}{\partial x} \right)_t$$

قانون اول فیک در ساختار s.c

$$D = \frac{\alpha^2}{6} \rightarrow \text{ضریب نفوذ}$$

می‌دانیم که در ساختار s.c $a_0 = 2R = \alpha$

$$\alpha = \frac{a_0 \sqrt{3}}{2} \leftarrow 2 \times 2R = a_0 \sqrt{3} \leftarrow 4R = a_0 \sqrt{3} \leftarrow \text{در ساختار BCC}$$

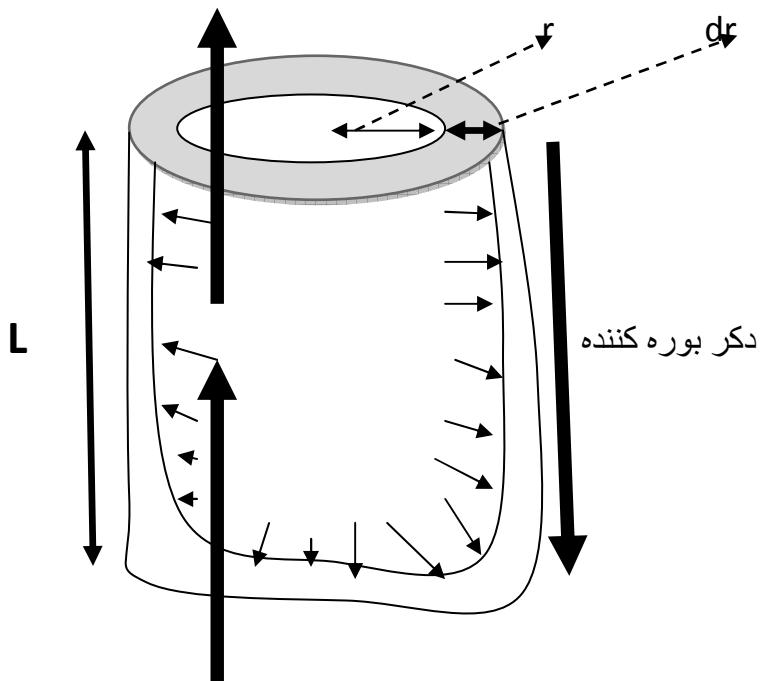
$$D_{BCC} = \frac{1}{6} \left(\frac{a_0 \sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} a_0^2$$

$$\alpha = \frac{a_0 \sqrt{2}}{2} \leftarrow 2\alpha = a_0 \sqrt{2} \leftarrow 2 \times 2R = a_0 \sqrt{2} \leftarrow 4R = a_0 \sqrt{2} \leftarrow \text{در ساختار FCC}$$

$$D_{FCC} = \frac{1}{6} \left(\frac{a_0 \sqrt{2}}{2} \right)^2 = \frac{1}{12} a_0^2$$

کاربرد قانون اول فیک:

مثال ← آزمایش اسمیت (سیلندری تو خالی از جنس آهن را در نظر بگیرید که در قسمت ایزوترم (هم دما) کوره نگه داشته شده است . یک گاز کربوره کننده از داخل سیلندر و یک گاز دکربوره کننده از خارج سیلندر عبور داده می شود . زمانی که غلظت کربن در نقاط مختلف سیلندر نسبت به زمان ثابت شد مقدار کربنی را که در واحد زمان از سیلندر عبور می کند را با توجه به اینکه به میزان ثابت $\frac{q}{t}$ می رسد را بدست آورید ؟



گاز کربوره کننده (باعث کربن دهی به قطعه می شود)

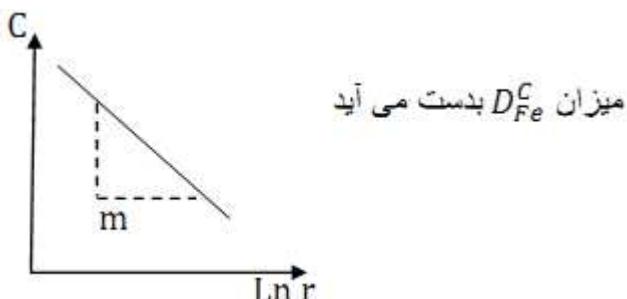
$$\frac{q}{t} = A_{\text{جانبی}}$$

$$\gamma = \frac{q}{A \cdot t} = \frac{q}{2\pi r l \cdot t} \quad \square$$

$$j = -D \left(\frac{\partial c}{\partial x} \right) \quad \square$$

$$-D \left(\frac{dc}{dr} \right) = \frac{q}{2\pi r l \cdot t} \rightarrow \frac{q}{t} = -D (2\pi r L) \left(\frac{dc}{dr} \right) \rightarrow \boxed{\frac{dr}{r} = d \ln r} \rightarrow \frac{q}{t} = -D (2\pi L) \frac{dc}{d \ln r}$$

$$q = -D (2\pi L \cdot t) \frac{dc}{d \ln r} \rightarrow y = mx \rightarrow m = \frac{y}{x} = \frac{dc}{d \ln r} \rightarrow \frac{dc}{d \ln r} = \frac{-q}{D 2\pi r L t}$$



ضریب نفوذ (D) :

ضریب نفوذ به گونه‌ی در حال نفوذ، محیطی که در آن نفوذ صورت می‌گیرد و دما بستگی دارد.

عوامل موثر بر ضریب نفوذ:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> ۱) جامد جانشین ۲) جامد بین نشین | <ol style="list-style-type: none"> ۱) نوع محلول جامد ۲) نوع فاز ۳) مکانیزم نفوذ ۴) دما ۵) غلظت ۶) اندازه اتم نفوذ کننده |
|--|---|

(۱) نوع محلول جامد: همیشه ضریب نفوذ در محلول جامد بین نشین بیشتر از محلول جامد جانشین است $D_I \approx 10^5$ تا $10^3 D_S$.

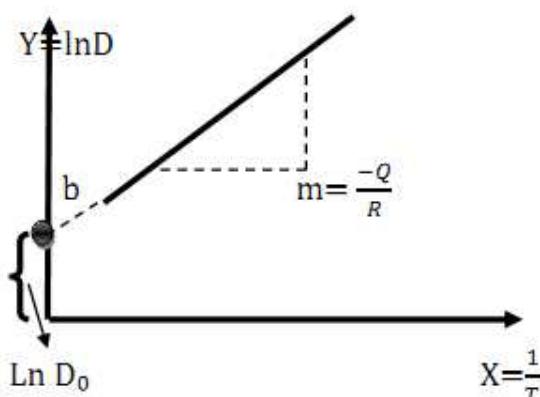
(۲) نوع فاز: ضریب نفوذ در حالت گاز بیشتر از حالت مایع و در مایع بیشتر از جامد است.

(۳) مکانیزم نفوذ: نفوذ ممکن است از طریق سطح، مرز دانه و یا حجم کریستال رخ دهد. برای محاسبه نفوذ حجمی از پک تک کریستال استفاده می‌کنیم.

(۴) دما: با افزایش دما میزان ضریب نفوذ افزایش می‌یابد طبق رابطه زیر:

$$D = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right) \quad \uparrow D \quad \uparrow T$$

$$\ln D = \ln D_0 - \frac{Q}{RT} \rightarrow y = b - mx$$



با رسم منحنی $\ln D$ بر حسب $\frac{1}{T}$ ام و محاسبه b

شیب خط و مقدار عرض از مبدأ می‌توانیم

مقدار Q (انرژی فعالسازی) و D_0 را بدست آوریم.

$= D_0$ ثابت تناسب

$= Q$ انرژی فعالسازی

$= R$ ثابت گازها

$= T$ دما (کلوین)

$=$ دما (کلوین)

۶) اندازه اتم نفوذ کننده

هرچه اندازه اتم نفوذ کننده کوچکتر باشد ، ضریب نفوذ بیشتر می شود . چون با کاهش اندازه ای قطر اتم نفوذ کننده انرژی فعال سازی کاهش می یابد . \downarrow اندازه اتم $\downarrow Q \quad \uparrow D$

کاهش اندازه اتم

اتم	
C	84.1
N	76.1
H	13.4

مثال (با افزایش دما از 900°C به 950°C ضریب نفوذ عنصر A در فلز B به میزان 10 برابر افزایش می یابد مقدار انرژی فعالسازی یک مول از عنصر A برای نفوذ در عنصر B چقدر است ؟

اطلاعات مسئله : برابر $D_A^B = 10$

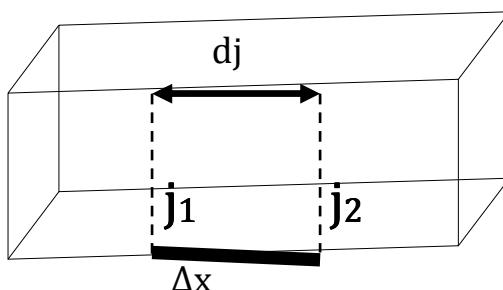
جواب :

$$\left\{ \begin{array}{l} D_1 = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT_1}\right) \\ \\ D_2 = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT_2}\right) \\ \\ \rightarrow \ln \frac{D_2}{D_1} = \frac{-Q}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \rightarrow \ln 10 = \frac{-Q}{R} \left(\frac{1}{1223} - \frac{1}{1173} \right) \rightarrow \\ \\ -\frac{Q}{R} = 66065 \quad \begin{cases} Q = 66065 \times 8.314 \quad \frac{j}{mol.k} \\ Q = 66065 \times 1.987 \quad \frac{cal}{mol.k} \end{cases} \end{array} \right.$$

دلیل بیان قانون دوم فیک:

سیستم های پایا (تعادلی) دارای دو مشکل می باشند : \square غلظت با گذشت زمان تغییر می کند $\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_t \neq 0$

\square تغییر غلظت به نوبه ای خود سبب تغییر ضریب نفوذ می شود.



فرض می کنیم که:

$$j_2 > j_1$$

رابطه ۱:

$$\text{انباشت اتم در واحد حجم} \rightarrow A = J_2 - J_1$$

رابطه ۲:

$$A = \frac{\partial c}{\partial t} \cdot dx$$

رابطه ۳:

$$\rightarrow \text{قانون اول فیک} \rightarrow j = -D \frac{dc}{dx}$$

رابطه ۴:

$$j_2 = j_1 + dj$$

با توجه به برابری طرفین رابطه ۱ و ۲ خواهیم داشت :

$$\frac{\partial c}{\partial t} \cdot dx = j_2 - j_1 \rightarrow \frac{\partial c}{\partial t} \cdot dx = j_1 + dj - j_1 \rightarrow \frac{\partial c}{\partial t} \cdot dx = dj$$

با قرار دادن مقدار j از رابطه ۳ خواهیم داشت :

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{dj}{dx} \rightarrow \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{d}{dx} \left(-D \frac{dc}{dx} \right) \rightarrow$$

**فرض (الف) ضریب
نفوذ نسبت به x و t
ثابت باشد**

$$\rightarrow \frac{\partial c}{\partial t} = -D \frac{d}{dx} \left(\frac{dc}{dx} \right) \rightarrow$$

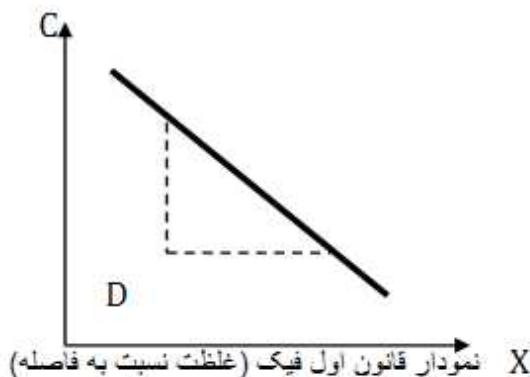
قانون دوم فیک :

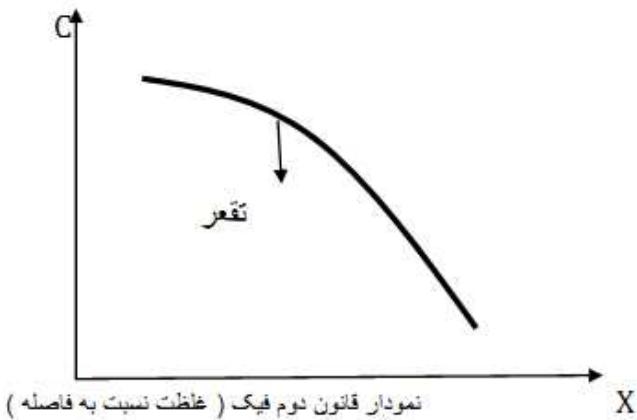
$$\frac{\partial c}{\partial t} = -D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

قانون اول فیک :

$$j = -D \frac{\partial c}{\partial x}$$

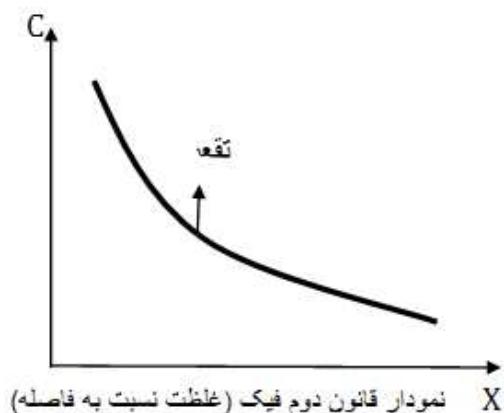
نمودار ها :





نکته: وقتی نکره منحنی رو به پایین است
 $\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} < 0$ یعنی با گذشت زمان
 غلظت کاهش می یابد

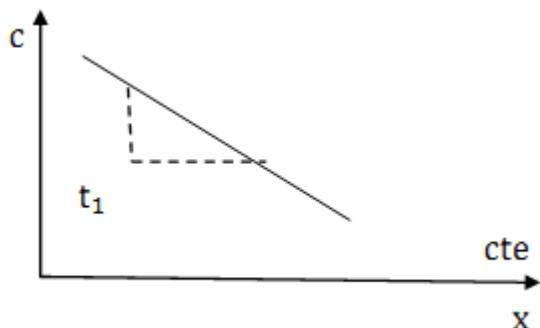
نکته: ضریب نفوذ (D) همواره عددی مثبت است.



نکته: وقتی نکره منحنی رو به بالاست
 $\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} > 0$ یعنی با گذشت زمان
 غلظت افزایش می یابد

تمرین: اثبات کنید که قانون اول فیک جزئی از قانون دوم فیک است یا به عبارتی دیگر با استفاده از قانون دوم فیک می توانیم به قانون اول برسیم؟

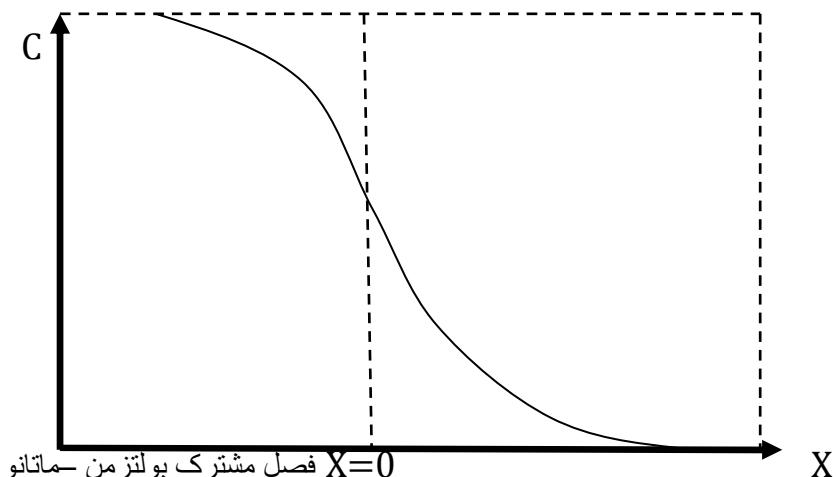
$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \quad \text{سهموی} \\ \frac{\partial c}{\partial t} = 0 \quad \xrightarrow{\text{در قانون اول فیک}} D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} = 0 \quad D \neq 0 \\ \frac{\partial c}{\partial t} = \text{cte} \quad \text{خطی} \\ \rightarrow \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} = 0 \rightarrow \int \rightarrow \frac{\partial c}{\partial x} = \quad \rightarrow \text{در زمان بی نهایت} \end{array} \right.$$



فرض (ب) : ضریب نفوذ (D) ثابت باشد :

بولتزمن - ماتانو : روش ترسیمی (گرافیکی) :

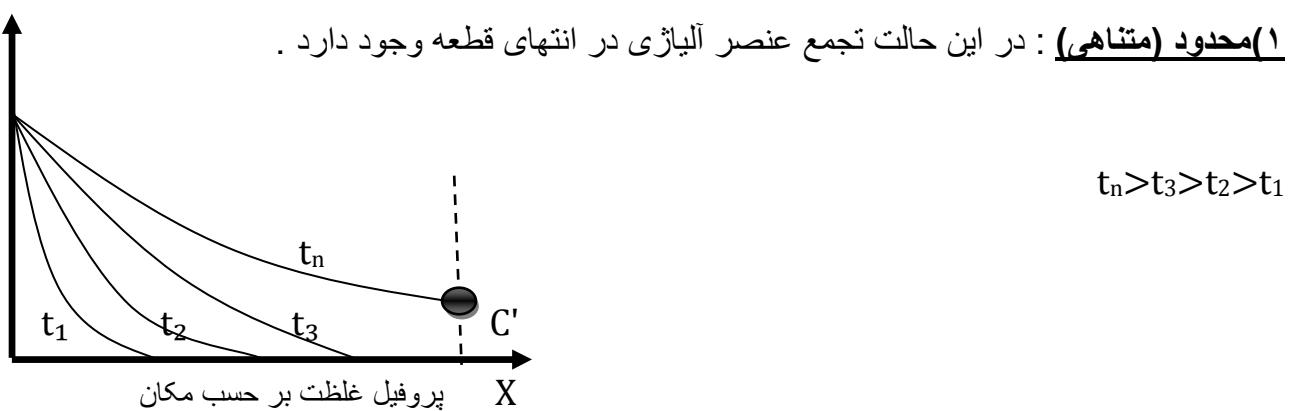
$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{d}{dx} \left(D \frac{\partial C}{\partial x} \right) \rightarrow D(C') = \frac{-1}{2t} \left(\frac{dx}{dc} \right)_{c'} \int_0^{C'} x dc$$



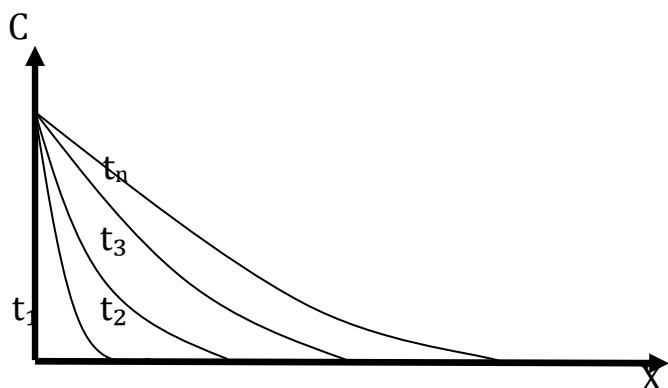
D	C	X
D ₁	C ₁	X ₁
D ₂	C ₂	X ₂
D ₃	C ₃	X ₃
:	:	:
:	:	:

انواع سیستم در خواص فیزیکی :

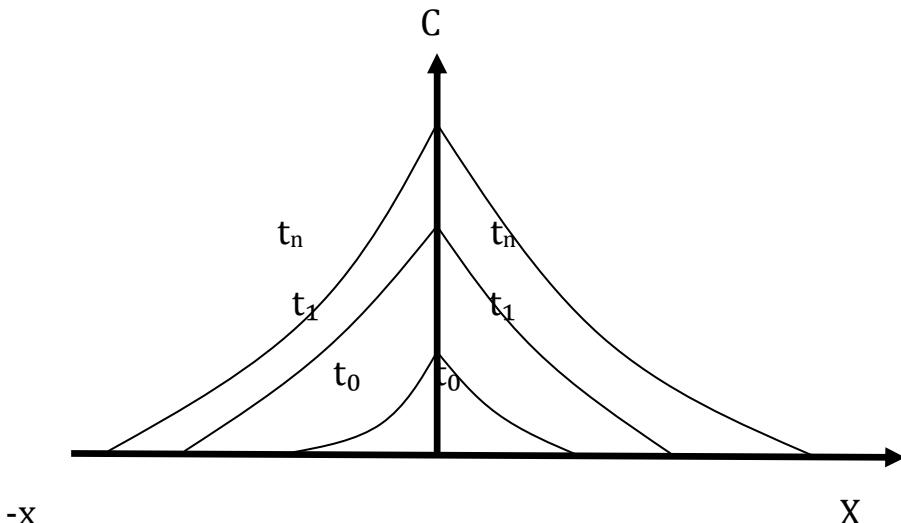
۱) محدود (متناهی) : در این حالت تجمع عنصر آلیاژی در انتهای قطعه وجود دارد.



۲) نیم محدود (نیم متناهی) : در این حالت تجمع عنصر آلیاژی در انتهای قطعه نداریم. (فقط در یک جهت)

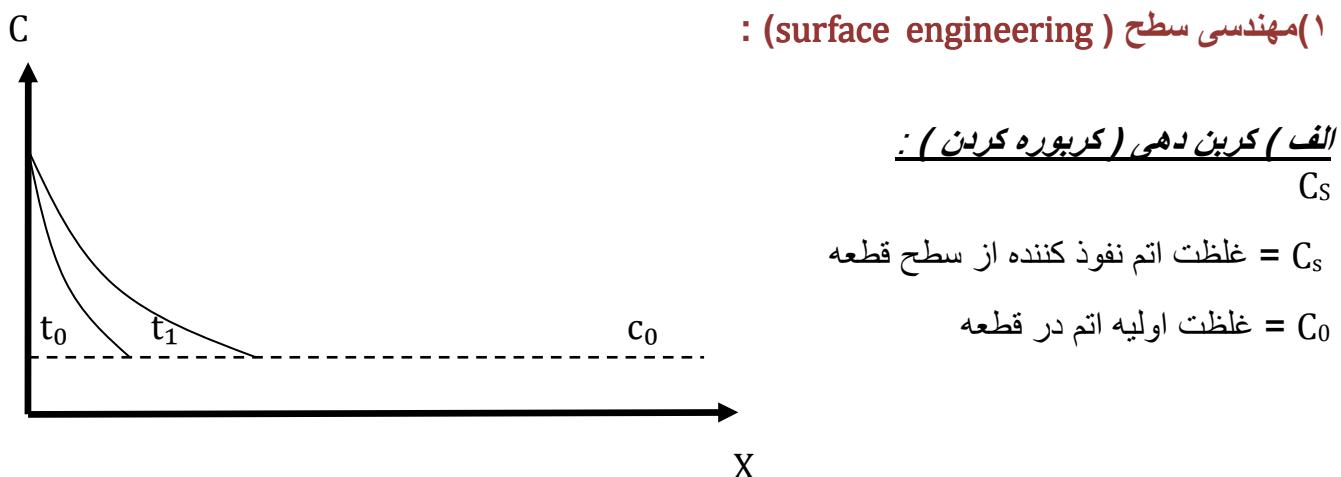


۳) نامحدود (نامتناهی) :



کاربرد های قانون دوم فیک :

- (۱) مهندسی سطح (هدف از مهندسی سطح افزایش سختی و مقاومت به سایش است)
- (۲) همگن سازی
- (۳) فیلم نازک (thin film)



کربن دهی از قانون دوم فیک تبعیت می کند

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \rightarrow \boxed{\begin{array}{l} t=0 \quad x>0 \quad c=c_0 \\ t>0 \quad x=0 \quad c=c_s \end{array}} \rightarrow$$

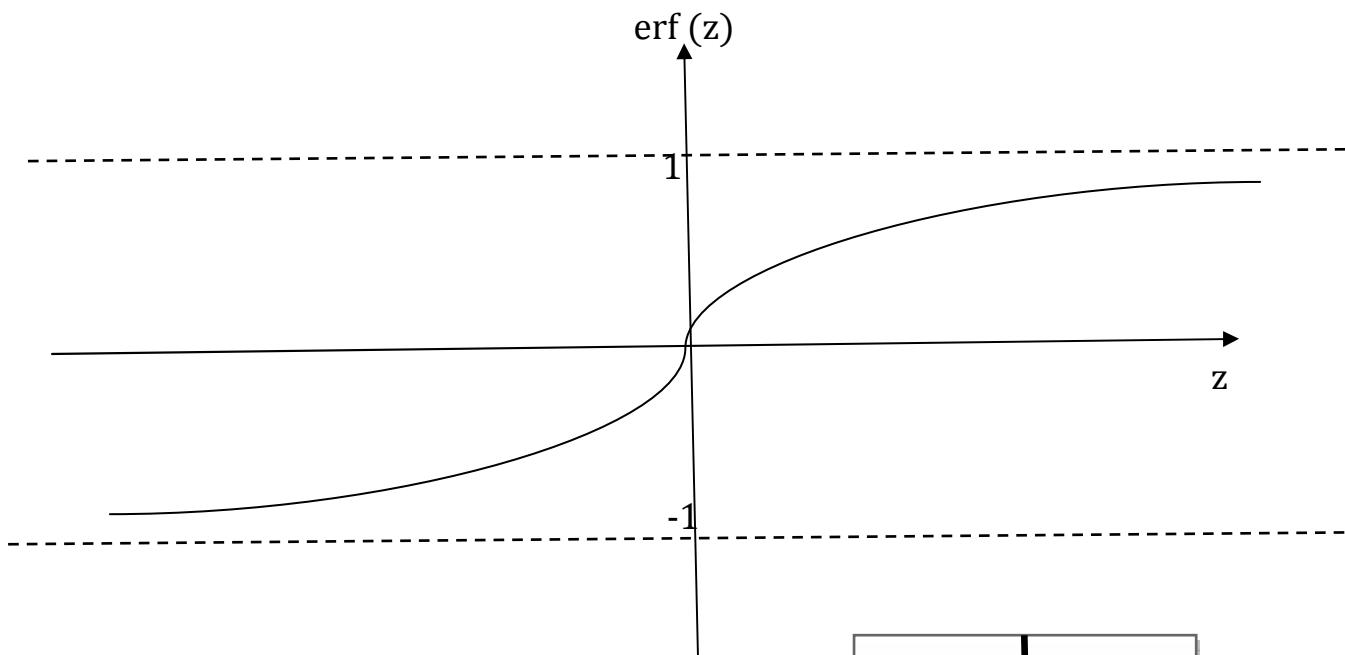
با حل قانون دوم فیک در شرایط مرزی فوق خواهیم داشت:

$$\frac{c_s - c_x}{c_s - c_0} = \text{erf} \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right)$$

c_x = غلظت اتم نفوذ کننده در فاصله X از سطح قطعه

t = زمان عملیات حرارتی D = ضریب نفوذ X = فاصله از سطح قطعه

erf = تابع خطأ (error function)



غلظت در سطح همواره ثابت و برابر با مقدار C_s می باشد.

Z	erf(z)
$-\infty$	-1
$+\infty$	+1
0	0
0.2	0.227

مثال) می خواهیم یک چرخ دنده از جنس فولاد 1020 را کربن دهی نماییم به طوری که غلظت در فاصله $x=0.5$ میلیمتری از سطح قطعه به 0.4 درصد برسد . اگر غلظت کربن در سطح قطعه 0.9 درصد باشد و دمای محیط $T=927^{\circ}\text{C}$ باشد زمان لازم را بدست آورید . (فرض کنید $\text{erf}(z) \approx z$)

$$C_s = 0.9\% \quad x = 0.5 \text{ mm} \quad C_x = 0.4\% \quad T = 927^{\circ}\text{C}$$

$$\frac{C_s - C_x}{C_s - C_0} = \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \rightarrow \frac{0.9 - 0.4}{0.9 - 0.1} = \text{erf}\left(\frac{0.5 \times 10^{-3}}{2\sqrt{1.28 \times 10^{-11} \times t}}\right) \rightarrow \frac{0.5}{0.7} = 0.71 = \text{erf}(z) \approx z \rightarrow$$

$$0.71 = \frac{0.5 \times 10^{-3}}{2\sqrt{1.28 \times 10^{-11} \times t}} \rightarrow t = 8567 \text{ s}$$

مثال ۲) مشخص نمایید در زمان معلوم t در چه عمقی از قطعه غلظت به نصف مجموع غلظت سطح و غلظت اولیه می رسد ؟

$$\frac{C_s - \frac{C_s + C_0}{2}}{C_s - C_0} = \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \rightarrow \frac{\frac{2C_s - C_s - C_0}{2}}{C_s - C_0} = \frac{\frac{C_s - C_0}{2}}{C_s - C_0} = 0.5 \rightarrow 0.5 = \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \rightarrow$$

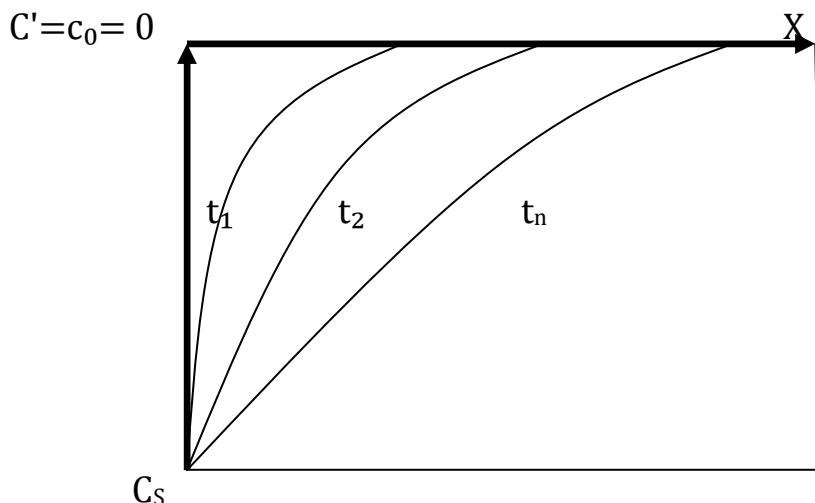
فرض $(z) \approx z$

$$0.5 = \frac{x}{2\sqrt{Dt}} \rightarrow x \approx \sqrt{Dt}$$

نکته : به x که غلظت در آن به نصف غلظت سطح برسد عمق کربوره کردن می گویند .

ب) ذکر بوره کردن:

$$\frac{c_s - c_x}{c_s - c_0} = C' \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \rightarrow \boxed{\text{شرط مرزی}} \rightarrow \begin{cases} t = 0 & x > 0 \\ x = 0 & t > 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} c = c' \\ c = 0 \end{matrix} \rightarrow$$

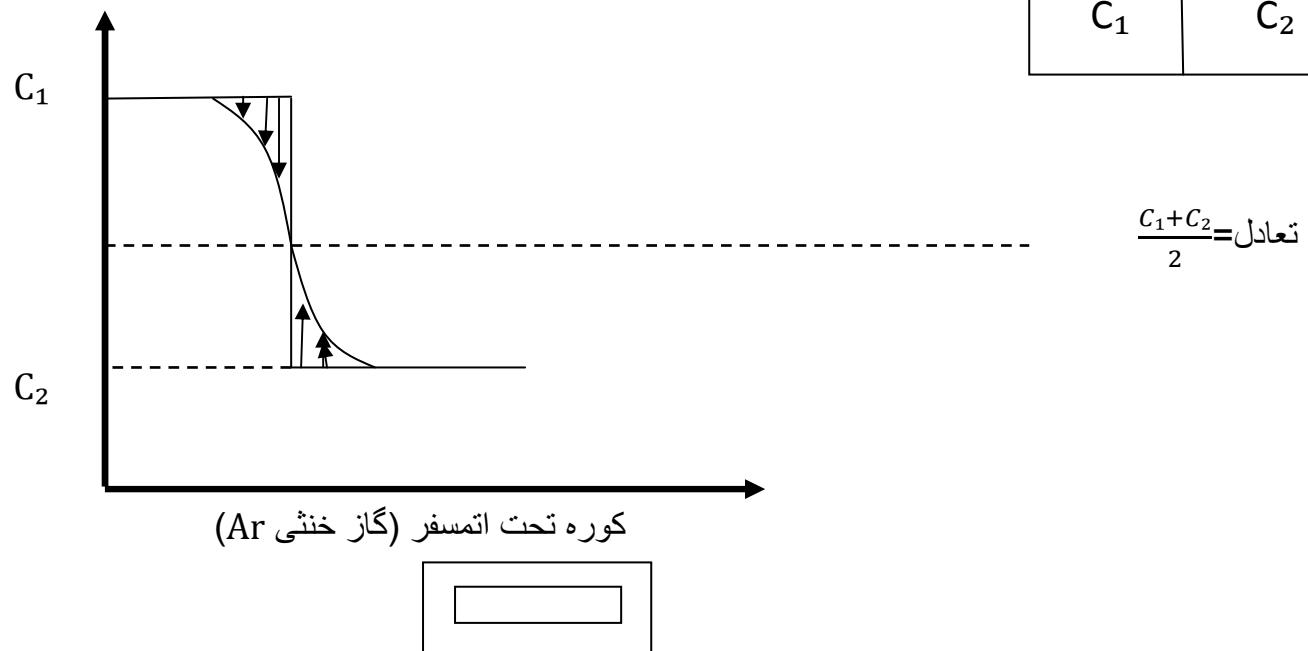


ج) کربوره - ذکر بوره:

$$C(X,t) = \left(\frac{C_1 + C_2}{2}\right) - \left(\frac{C_1 - C_2}{2}\right) \operatorname{erf}\left(\frac{X}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

$$C_1 > C_2$$

C ₁	C ₂
----------------	----------------



مثال) مدیر یک کارگاه عملیات حرارتی برای طولانی تر کردن عمر کوره های عملیات حرارتی خود تصمیم می گیرد که درجه حرارت کربوره کردن از 1000°C به 900°C کاهش بدهد و در عوض مدت زمان کربوره کردن را 10% افزایش دهد . اگر در هر دو درجه حرارت غلظت اولیه کربن ، غلظت کربن در سطح و غلظت کربن در فاصله i 0.025 cm از سطح قطعات به ترتیب 0.3% و 0.909% و 0.81% باشد و انرژی اکتیو اسیون نفوذ $\left(\frac{J}{mol}\right)$ 144000 باشد مشخص کنید تصمیم گرفته شده صحیح است یا نه؟

$$D = D_0 e^{\left(\frac{-Q}{RT}\right)} \rightarrow \frac{D_1}{D_2} = \frac{D_0 e^{\left(\frac{-Q}{RT_1}\right)}}{D_0 e^{\left(\frac{-Q}{RT_2}\right)}} = \frac{e^{\left(\frac{-Q}{RT_1}\right)}}{e^{\left(\frac{-Q}{RT_2}\right)}} = e^{\left(\frac{-Q}{RT_1}\right)} - e^{\left(\frac{-Q}{RT_2}\right)} = \frac{-Q}{RT_1} e^{-\left(-\frac{Q}{RT_2}\right)} \rightarrow$$

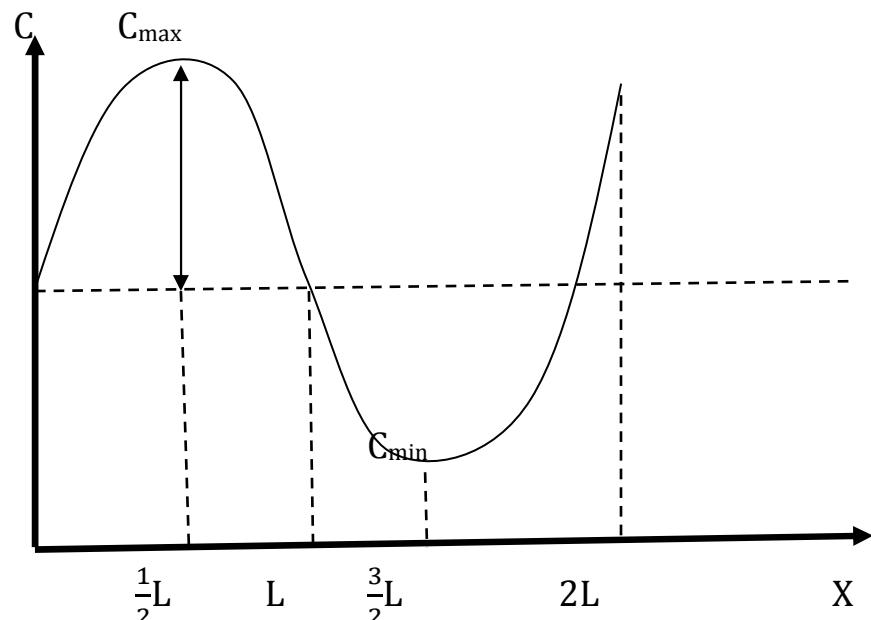
$$\ln\left(\frac{D_1}{D_2}\right) = \frac{-Q}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) = \frac{-14000}{8.314} \left(\frac{1}{1273} - \frac{1}{1173}\right) \rightarrow \frac{D_1}{D_2} = 3.2 \rightarrow \frac{C_S - C_X}{C_S - C_0} = \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \rightarrow$$

چون طرفین سمت چپ با هم برابر هستند سمت راست نیز با هم برابر خواهد شد:

$$\frac{x_1}{2\sqrt{D_1 t_1}} = \frac{x_2}{2\sqrt{D_2 t_2}} \rightarrow D_1 t_1 = D_2 t_2 \rightarrow D_1 t_1 = 3.2 D_1 t_2 \rightarrow \frac{t_1}{t_2} = 3.2$$

$$\text{درصد افزایش زمان} = \frac{t_{1273} - t_{1173}}{t_{1173}} = \frac{3.2 t_2 - t_2}{t_2} = \frac{3.2 - 1}{1} \times 100 = 220\%$$

(۲) همگن سازی :



$$C(x,t) = \bar{C} + \beta_0 \sin\left(\frac{n\pi}{L}\right) \times \exp\left(\frac{-t}{\tau}\right)$$

$$\beta_0 = C_{\max} - \bar{C} \quad \text{دامنه غلظت} = \beta_0$$

$$\bar{C} = \frac{C_{\min} + C_{\max}}{2} \quad \text{غلظت میانگین} = \bar{C}$$

$$D = \text{ضریب نفوذ} \quad \tau = \frac{L^2}{\pi D^2} \quad \text{زمان استراحت} = \tau \quad \text{زمان همگن سازی} = t$$

$$C\left(\frac{1}{2}, t\right) = \bar{C} \quad \text{همگن شده}$$

$$t_s = m\tau_s$$

$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{3L}{2}, \frac{5L}{2}, \dots \dots \dots \right. \\ \left. L, 2L, 3L, \dots \dots \dots \right.$$

حداکثر اختلاف غلظت

حداقل اختلاف غلظت

نکته: هر وقت حداکثر های غلظت به مقدار \bar{C} بر سر آنگاه قطعه همگن شده است

$$C\left(\frac{1}{2}, m\tau\right) = \bar{c} + \beta_0 \sin\left(\frac{n\pi}{L}\right) \left(\frac{L}{2}\right) \exp\left(\frac{-m\tau}{\tau}\right)$$

$$C\left(\frac{1}{2}, m\tau\right) = \bar{c} + \beta_0 \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \exp(-m)$$

$$C\left(\frac{1}{2}, m\tau\right) = \bar{c} + \beta_0 \exp(-m) = \bar{c} + \beta_0 e^{-m} \rightarrow \begin{cases} \beta_0 e^{-m} = 0 \\ \beta_0 \neq 0 \end{cases} \rightarrow e^{-m} = 0$$

راه های کاهش زمان همگن سازی :

- ۱) سریع سرد کردن
- ۲) جوانه زدن
- ۳) هم زدن
- ۴) لرزش

۱) طول دنبیت را کاهش می دهیم از طریق:

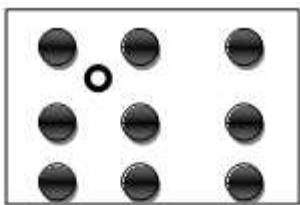
$$\tau = \frac{L^2}{\pi D^2}$$

۲) را افزایش می دهیم ← از طریق زیاد کردن دما

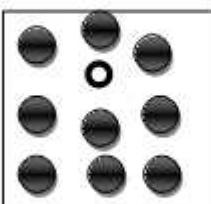
mekanizm hāy nafud bīn nashin و jānshin و māyis hāy ān hā :

۱) نفوذ بین نشین :

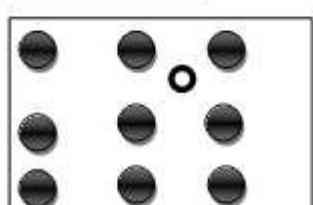
①



②



③



$$D = \frac{1}{6} \alpha^2 : A$$

$$\varnothing = Z \varnothing \exp\left(\frac{-Q_m}{RT}\right) : B$$

با قرار دادن رابطه B در A خواهیم داشت :

$$D_i = \frac{1}{6} \alpha^2 z \exp\left(\frac{-\Delta G_M}{RT}\right)$$

$$\Delta G_m = \Delta H_m - T \Delta S_m \rightarrow$$

$$\rightarrow D_i = \frac{1}{6} Z \varnothing \alpha^2 \exp\left(\frac{-\Delta H_m + T \Delta S_m}{RT}\right) \rightarrow$$

$$D_i = \frac{1}{6} Z \varnothing \alpha^2 \exp\left(\frac{-\Delta H_m}{RT}\right) \exp\left(\frac{\Delta S_m}{R}\right)$$

□

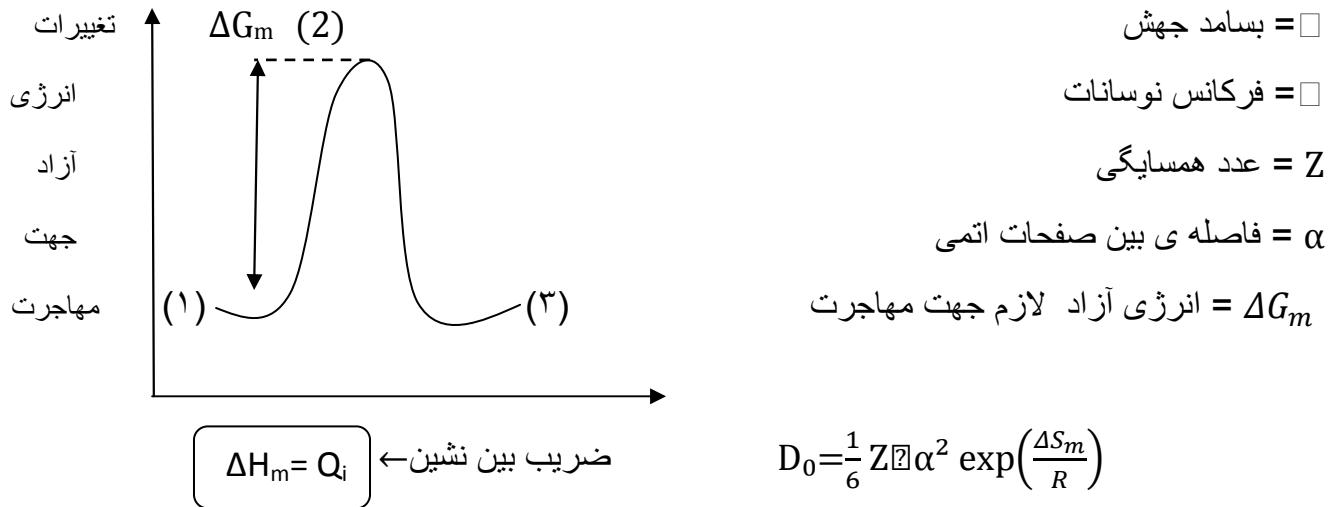
$$D_{کلی} = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right)$$

رابطه \varnothing

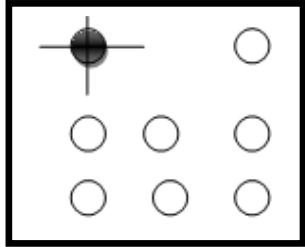
$$Q = \Delta H$$

از مقایسه \square و \varnothing نتیجه می گیریم که :

انرژی لازم جهت مهاجرت بین نشین



نفوذ جانشین :



كسر جای خالی = X_V

$$D = \frac{1}{6} Z \alpha^2$$

$$= Z D x_v \exp\left(-\frac{\Delta G_m}{RT}\right)$$

$$X_V^e = \exp\left(-\frac{\Delta G_V}{RT}\right)$$

$$\Delta G_m = \Delta H_m - T \Delta S_m$$

$$\Delta G_V = \Delta H_V - T \Delta S_V$$

با قرار دادن در خواهیم داشت :

$$= Z X_V \exp\left(-\frac{\Delta H_m}{RT}\right) \exp\left(\frac{\Delta S_m}{R}\right)$$

با قرار دادن در خواهیم داشت :

$$X_V^e = \exp\left(-\frac{\Delta H_V}{RT}\right) \exp\left(\frac{\Delta S_V}{R}\right)$$

با قرار دادن در خواهیم داشت :

$$= Z \exp\left(-\frac{\Delta H_V}{RT}\right) \exp\left(\frac{\Delta S_V}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H_m}{RT}\right) \exp\left(\frac{\Delta S_m}{R}\right)$$

با قرار دادن در خواهیم داشت :

$$D_S = \frac{1}{6} Z \alpha^2 \exp\left(-\frac{(\Delta H_V + \Delta H_m)}{RT}\right) \exp\left(\frac{\Delta S_V + \Delta S_m}{R}\right) \leftarrow B$$

$$D_0 = \frac{1}{6} Z \alpha^2 \exp\left(\frac{\Delta S_V + \Delta S_m}{R}\right)$$

$$C \rightarrow \text{رابطه} \quad D_i = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right)$$

با منتظر قرار دادن C و B خواهیم داشت :

$$D_S < D_i \quad \leftarrow \quad Q_S > Q_i \leftarrow \quad Q_S = \Delta H_V + \Delta H_m$$

مقایسه ی D_i و D_V :

پرش اتم بجای خالی دقیقاً معادل پرش جای خالی بجای اتم است از طرفی چون پرش جای خالی بجای اتم بوسیله محل های مناسب احاطه شده یعنی جای خالی بجای هر اتم مجاور خود می تواند قرار گیرد پس مشابه به حالت بین نشین است .
 $D_i = D_V$

مقایسه ی ضریب نفوذ جانشین و فضای خالی :

$$\frac{D_V = D_i}{D_S} = \frac{1}{X_V} \rightarrow D_S = X_V D_V \rightarrow D_S < D_V$$

ضریب نفوذ در خود (SELF DIFFUSION) :

این فرآیند در خزش در سوپر آلیاژ ها اهمیت زیادی دارد و مبنای نفوذ اتم ها در ماده ای از همان جنس است . روش مرسم جهت تعیین ضریب نفوذ در خود D رسوب دادن مقدار معلومی (به میزان m) از یک رادیو اکنیو روی انتهای های دو میله از جنس همان فلز می باشد که پس از رسوب دادن این دو میله به یکدیگر متصل شده زمان مشخص در دمای ثابت قرار می گیرد . در این حالت فلز رادیواکتیو شده در فلز اصلی نفوذ نموده و در پایان آزمایش می توانیم منحنی غلظت را بدست آوریم (همانند فیلم نازک)

$$C = \frac{m}{2\sqrt{\pi D t}} \exp\left(\frac{-x^2}{4Dt}\right)$$

C = غلظت عنصر رادیواکتیو در فواصل x و زمان t

m = مقدار ماده رسوب داده شده در انتهای میله

پدیده کرکنده یا ضریب نفوذ در هم \tilde{D} :

یک محول دو تایی تشکیل شده از دو فلز A و B که در حالت

جامد کاملاً در هم محلول می باشند ولی ضریب نفوذ های متفاوتی دارن را در نظر بگیرید . طبق آزمایش انجام شده توسط کرکنده ، مکانیزم نفوذ از طریق جاهای خالی اثبات می شود . در این آزمایش پس از اتصال دو فلز و پیش از فرآیند آنلیل در محل اتصال این دو فلز یکسری نشانه های خنثی (فلزات با نقطه ذوب بالا و غیر قابل حل مانند MnO و وانادیم و تنگستن) قرار داده می شود . پس از گذشت زمان T_1 مشاهده می شود که نشانه ها در حالت جامد شروع به جابجا شدن می نمایند در واقع علت این جابجا شدن ناشی از اختلاف نقطه ذوب آنهاست .

مثال (Cu-Ni سیستم) را در نظر بگیرید . در این سیستم چون نقطه ذوب مس کمتر از نیکل است بیشتر جابجا شده و ناحیه مس کوچک می شود و در نتیجه نشانه ها بسمت راست جابجا می شوند و در پایان مشاهده می شود که در قسمت مس تجمع ای از خلل و فرج ها وجود دارد که بیان اگر نفوذ از طریق تهی جاهاست .

تحلیل دارکن :

روابط دارکن : (رابطه ی بین D_B و D_A و \tilde{D}) :

→ پروفایل



سرعت حرکت مقتول →

رابطه‌ی اول : $V = (D_A - D_B) \frac{\partial N_A}{\partial X} \rightarrow$ سرعت حرکت مفتوح‌ها نسبت به عنصر A

رابطه‌ی ۲ : $V = (D_B - D_A) \frac{\partial N_B}{\partial X} \leftarrow$ سرعت حرکت مفتوح‌ها نسبت به عنصر B

رابطه‌ی سوم : $\tilde{D} = N_A D_B + N_B D_A$

در سه رابطه‌ی بالا با معلوم بودن مقادیر V ، \tilde{D} و $\frac{\partial N_A}{\partial X}$ و D_B تعیین می‌شوند.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial X} \left(D \frac{\partial C}{\partial X} \right) \xrightarrow{\text{قانون دوم فیز}} \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial X} \left(\tilde{D} \frac{\partial C}{\partial X} \right) \begin{cases} \text{الف) } \tilde{D} \text{ ثابت باشد} \\ \text{ب) } \tilde{D} \text{ متغیر باشد} \end{cases} \rightarrow \frac{\partial C}{\partial t} = \tilde{D} \frac{\partial^2 C}{\partial X^2}$$

روش حل قسمت الف)

$$\square C_A(X,t) = C_{A_1} + \frac{C_{A_2} - C_{A_1}}{2} \left(1 - erf \left(\frac{X}{2\sqrt{\tilde{D}} t} \right) \right)$$

$$\square C_B(X,t) = C_{B_1} + \frac{C_{B_2} - C_{B_1}}{2} \left(1 - erf \left(\frac{X}{2\sqrt{\tilde{D}} t} \right) \right)$$

روش حل قسمت (ب) :

از روش ترسیمی بولتزمن- ماتانو حل می‌شود .

نکته : همواره در آلیاژ‌ها ضریب نفوذ در هم، به طور تقریبی برابر است با ضریب نفوذ عنصر رقیق‌تر.

Fe — 0.1 C

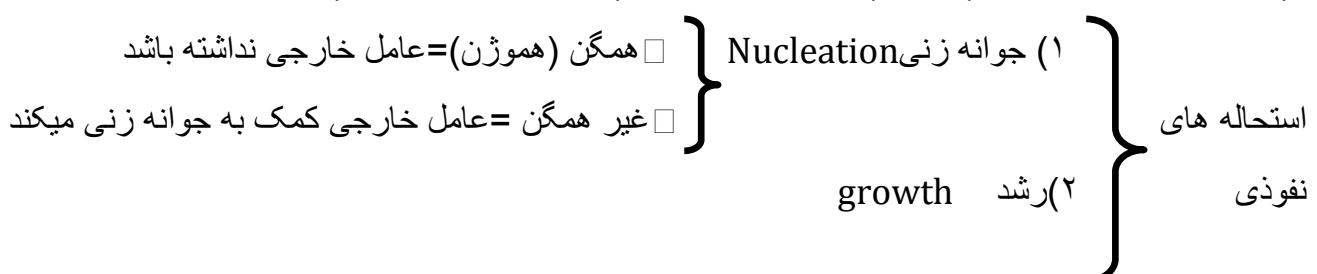
مثال) ضریب نفوذ کربن بیشتر است یا آهن ؟

$$\tilde{D} = N_{Fe} D_C + N_C D_{Fe} \rightarrow \tilde{D} = 99.9 D_C + 0.1 D_{Fe} \rightarrow \tilde{D} \approx D_C > D_{Fe}$$

استحاله‌های فازی در حالت جامد :

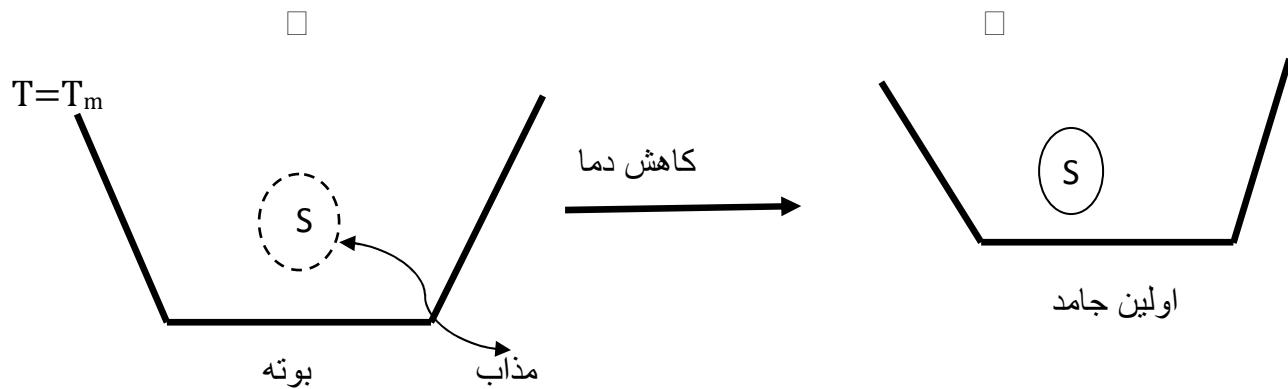
۱) استحاله‌های نفوذی Diffusion (مثل تشکیل شدن پرلیت) : در این نوع استحاله تک تک اتم‌ها به طور جداگانه جابجا می‌شوند .

۲) استحاله‌های غیر نفوذی (برشی) Diffusionless (مثل استحاله مارتزیت) .





جوانه زنی همگن:



$$G = V_L G_L^V + V_S G_L^V$$

$$G = V_L G_L^V + V_S G_S^V + A_{SL} G_{SL}$$

$$\Delta G_{TOTAL} = V_L G_L^V + V_S G_S^V + A_{SL} G_{SL} - V_L G_L^V - V_S G_L^V \rightarrow$$

نکته: به طور قرار دادی همیشه $\Delta G_V = G_L^V - G_S^V$

$$\Delta G_{TOTAL} = -V_S \Delta G_V + A_{SL} G_{SL}$$

$$\Delta G_{TOTAL} = -\frac{4}{3}\pi R^3 \Delta G_V + 4\pi R^2 A_{SL}$$

$$\rightarrow \frac{\partial \Delta G_{TOTAL}}{\partial R} = -4\pi R^2 \Delta G_V + 8\pi R A_{SL} = 0$$

$$\rightarrow 4\pi R (-R \Delta G_V + 2 A_{SL}) = 0 \quad \begin{cases} 4\pi R = 0 \\ R = \frac{2 A_{SL}}{\Delta G_V} \end{cases}$$

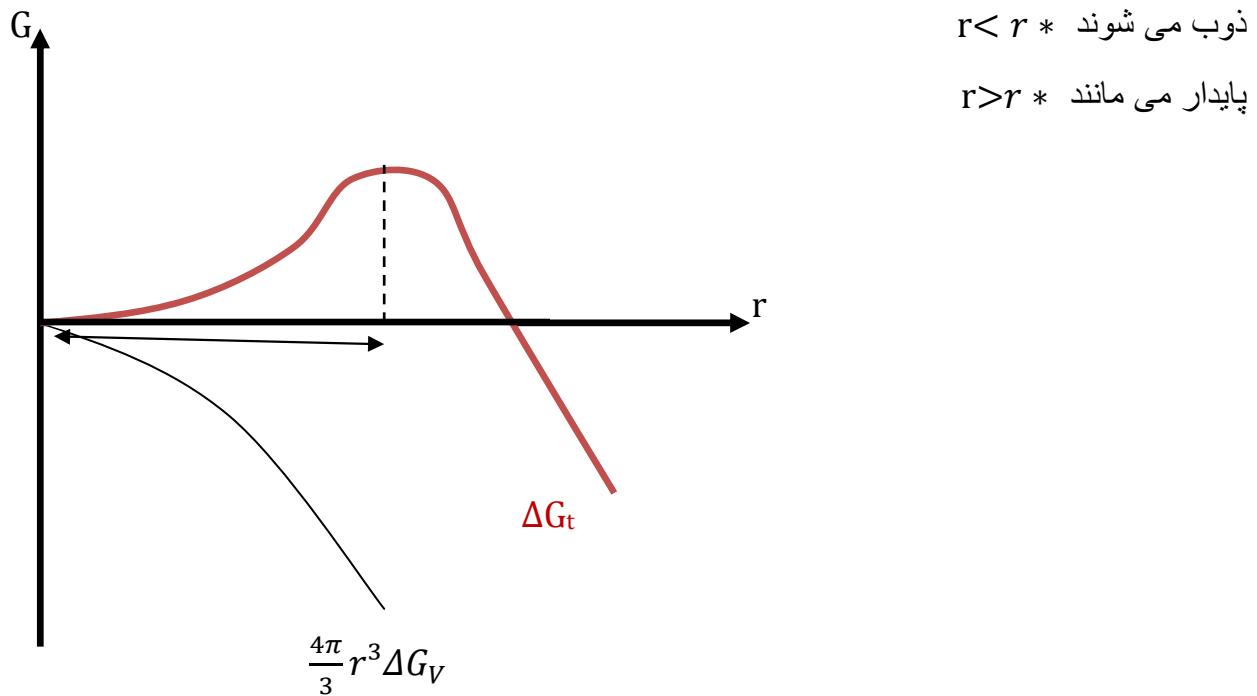
غیر
شعاع بحرانی

$$A_{SL} = G_L^V - G_S^V = \text{انرژی آزاد جامد} \quad V_S = \text{حجم جامد} \quad V_L = \text{حجم مذاب}$$

نکته: شعاع بحرانی جوانه زنی

$$r^* = \frac{2 A_{SL}}{\Delta G_V}$$

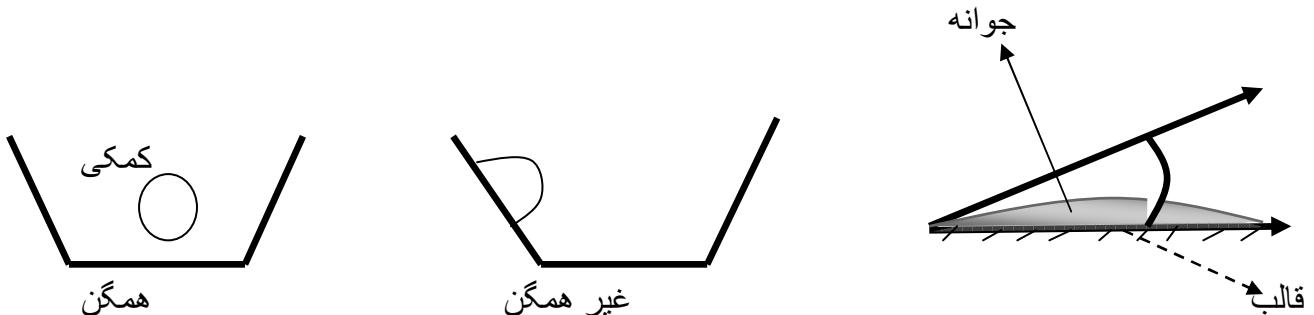
$$4\pi r^2$$



تمرین) با قرار دادن r^* در معادله ΔG_{TOTAL} ، مقدار ΔG^* را بدست آورید .
 $r^* = \text{انرژی بحرانی لازم جهت تشکیل جوانه با شعاع بحرانی} = \Delta G^*$

جوانه زنی غیر همگن :

$$A \rightarrow \Delta G_{het} = \Delta G_{hom} \cdot S(\theta)$$

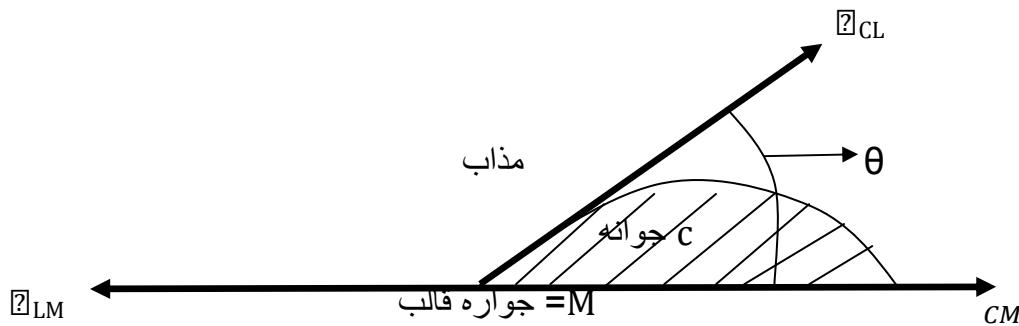


$$S(\theta) = \frac{(2 + \cos\theta)(1 - \cos\theta)^2}{4} \rightarrow S(\theta) = S(\theta)$$

$$0 < \theta < 180^\circ \rightarrow \begin{cases} \text{if } \theta = 0^\circ \rightarrow s(\theta) = 0 \\ \text{if } \theta = 180^\circ \rightarrow s(\theta) = 1 \end{cases} \rightarrow 0 < s(\theta) < 1$$

با قرار دادن مقدار $S(\theta)$ در رابطه A مشخص می شود که همواره ΔG_{het} کمتر از ΔG_{hom} است .

$$\Delta G_{het} < \Delta G_{hom} \quad (\text{همگن}) \quad (\text{غیر همگن}) \quad \text{انرژی فصل مشترک} \quad ?$$



$$LM = CM + CL \cos\theta \rightarrow \cos\theta = \frac{LM - CM}{CL}$$

ΔT = تحت تبرید یا تحت انجماد (supercooling or undercooling)

$$\Delta T_{het} < \Delta T_{hom} \rightarrow \begin{cases} \Delta T_{het} = 0.02 T_m \\ \Delta T_{hom} = 0.2 T_m \end{cases}$$

نکته : چنانچه فلزات را با سرعت های بیش از $\frac{^0C}{S} 10^6$ سرد نماییم جامد ایجاد شده آمورف خواهد بود چون اصلاً فرصت جوانه زنی پیدا نمی کند .

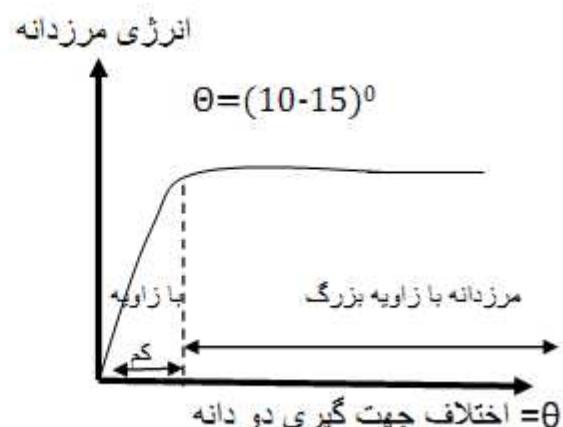
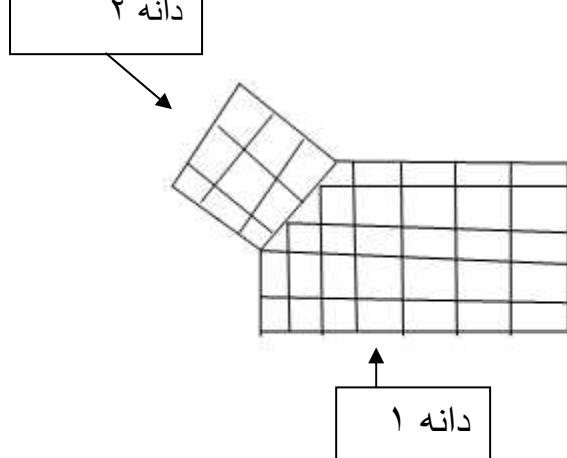
أنواع فصل مشترك ها :

□ فصل مشترك G / α ← جامد / گاز

فصل مشترك جامد گاز (G / α) شامل سطوح آزاد هر بلور است . هر اتمی دارای این نوع فصل مشترك می باشد اتم هایی که در شبکه قرار دارند با اتم های اطراف در ارتباط هستند ولی اتم های سطح از یک طرف آزاد هستند و تمایل به جذب اتم های محیط اطراف دارند حتی اتم های گاز به همین دلیل است که سطح تمیز برای فلزات معنی ندارد چون مقداری نیتروژن و اکسیژن جذب می نماید که این مسئله مربوط به تئوری پیوند ها یا باند های شکسته شده می باشد که اتم های آزاد فلز در محل شکست پیوند ها می توانند با ناخالصی ها پیوند برقرار کنند .

□ فصل مشترك α / α

۱-۲) فصل مشترك α/α با زاويه بزرگ :



در این حالت زاويه بین صفحات کریستالی دو دانه زیاد است (بیش از ۱۰ الی ۱۵ درجه) در مرز دانه با زاويه ای زیاد انرژی مرزدانه از اختلاف جهت گیری دو دانه تبعیت نمی کند در این حالت به مقداری هسته

های نابجایی به اندازه ای همپوشان می شوند که نمی توانیم آن ها را به طور مجزا از یکدیگر تشخیص دهیم به عبارت دیگر در این حالت هیچ گونه نظم بلوری یا کریستالی وجود ندارد

۲-۲) فصل مشترک a/a با زاویه کم ($10 - 15^\circ$)

۱-۲-۲) کج = این نوع مرزها از ردیف شدن نابجایی ها در یک دانه به وجود می آیند و به آنها مرزهای فرعی نیز می گویند.

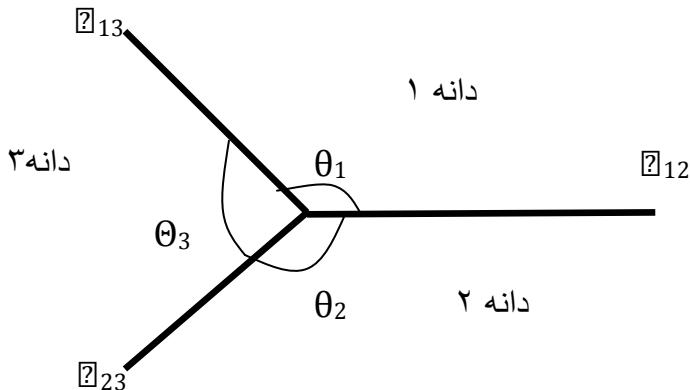
$$D = \frac{b}{\theta}$$

$$\text{زاویه} = \theta \quad \text{بردار برگردان} = b \quad \text{فاصله نابجایی} = D$$

۲-۲-۲) خمشی = در این حالت دو سلول (cell) که در مجاورت یکدیگر قرار گرفته اند نسبت به یکدیگر خم می شوند (در مرحله ای تبلور مجدد یا Recrystallization رخ می دهد)

۳-۲-۲) پیچشی : در این حالت تحت تاثیر نیروهای برشی دو سلول مجاور هم نسبت به یکدیگر دچار پیچش می شوند در این حالت ارتباط کریستالو گرافی یک سلول با سلول مجاورش حفظ می شود.

تعادل فصل مشترک :

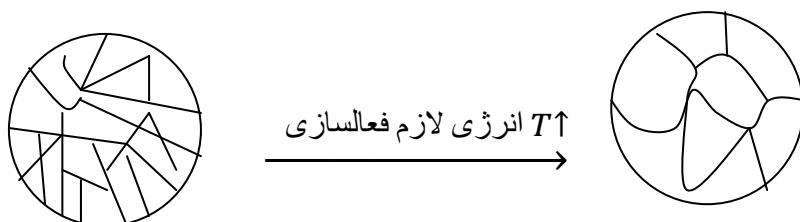


$$\text{فرض} \leftarrow \theta_{13} = \theta_{12} = \theta_{23}$$

$$\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = 120$$

$$\frac{\sin \theta_3}{\sin \theta_2} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_3} = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_1} \leftarrow \text{تعادل}$$

mekanizm رشد دانه :



دانه Al ریز

دانه Al درشت

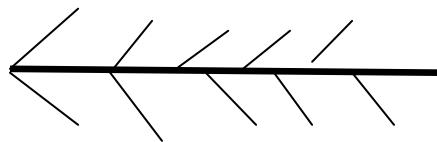
قرینه آینه ای

همدوس : (کوهیرنت)

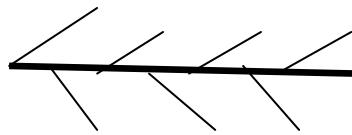
صفحه دوقلویی : مرز



نیمه همدوس :

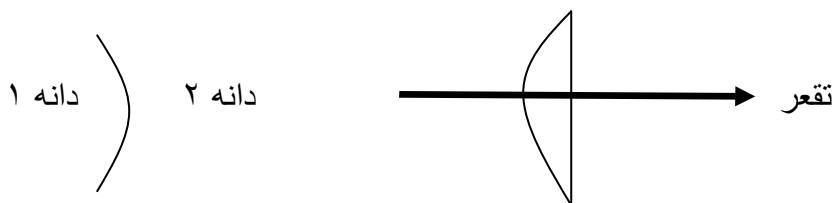


ناهمدوس :



همواره با افزایش دما رشد دانه اتفاق می افتد چون مرز دانه که محل های پر انرژی هستند کاهش می یابند

مثال) در شکل زیر مشخص نمایید مرز دانه به چه سمتی حرکت می کند و چرا ؟



با حرکت مرز به سمت راست چون میزان مرز دانه افزایش می یابد و منجر به افزایش انرژی سیستم می شود پس غیر قابل قبول است پس در واقع همواره مرزدانه ها به سمت تقرع خود حرکت می کنند تا جایی که تبدیل به یک خط راست شوند و انرژی سیستم را به حداقل مقدار ممکن برسانند .

= ثابت کننده یا پایدار کننده : Stablizer

اگر مرز دانه ای حاوی ذراتی روی آن باشد مرز دانه همراه با ذرات حرکت خواهد کرد که به آن ذرات فاز ثانویه می گویند علت آن است که اگر فرض کنیم مرزها با جا گذاشتن stabilizer ها حرکت می کنند به تنافض می رسیم چون از سطح با انرژی کمتر به سطح با انرژی بیشتری می رسیم به علت افزایش مرزدانه پس در نتیجه مرزدانه ها مجبورند همراه با stabilizer ها حرکت کنند و از آنجایی که حرکت مرزدانه ها و به بعد آن stabilizer ها بایستی با نفوذ انجام شود و سرعت نفوذ نیز پایین می باشد (نسبت به حالتی که stabilizer نباشد) پس رشد دانه ریز می یابد و در نتیجه دانه های ریزی خواهیم داشت .

مراحل حرکت stabilizer ها :

در هنگام نفوذ stabilizer باید ابتدا در فاز زمینه حل شود و سپس نفوذ نماید و پس از رسیدن به مقصد از حالت حلالیت خارج شود و دوباره تشکیل ذره فاز ثانویه را بدهد پس به طور کلی با توجه به مطالب بالا دو روش جهت جلوگیری و کنترل رشد دانه وجود دارد :

۱- stabilizer در فاز زمینه حل نشود

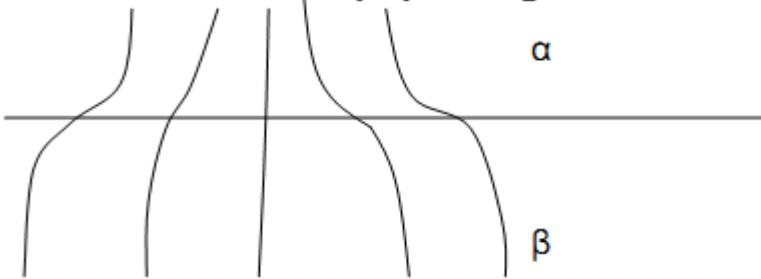
۲- اگر در فاز زمینه حل شد ضریب نفوذ بسیار پایینی داشته باشد مثلا کاربید تنگستن (WC)

مراحل کاربید تنگستن : ۱- پیوند C و W شکسته شود ۲- تک تک در ریشه حل می شوند ۳- تک تک نفوذ می کند

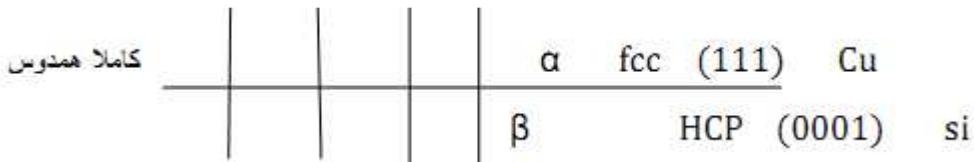
۴- پیوند برقرار شوند ۵- روی مرز رسوب کنند

□ فصل مشترک α / β

۱-۳) کاملاً کوهیرنت (همدوس) : انواع کوهیرنت : α و β ساختار های کریستالی یکسانی دارند ولی پارامتر شبکه آنها اختلاف اندکی با یکدیگر دارند.



<2> ساختار های کریستالی متفاوت (HCP و fcc) ولی در راستایی با یکدیگر پیوند برقرار می کند که بر هم منطبق شوند. مثل Cu-Si



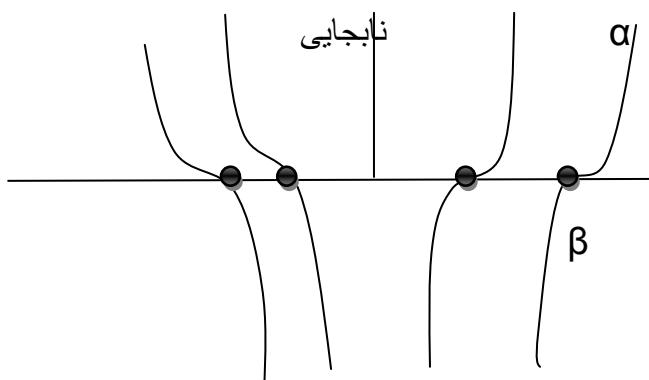
نکته) فصل مشترک های کوهیرنت حداقل میزان انرژی را دارند و انرژی آنها فقط ناشی از اختلاف پیوند شیمیایی می باشد.

$$\frac{m_j}{m^2} = \frac{\chi_{ch}}{\chi_{st}} = 200$$

۲-۳) نیمه همدوس (شبه همدوس) :

اختلاف پارامتر شبکه به اندازه ای است که توسط نابجایی ها جبران می شود.

$$\frac{m_j}{m^2} = \chi_{ch} + \chi_{st} = (200 - 500)$$



χ_{st} = ناشی از حضور نابجایی ها

فصل مشترکی است که در آن عدم تطابق های ایجاد شده با نابجایی برطرف می شود نیمه هم سیمایی (نیمه همدوس) تا زمانی حفظ می شود که فاکتور عدم تطابق (حداکثر اختلاف پارامتر شبکه) ۲۵٪ باشد.

۳-۳) غیر کوهیرنت (ناهمدوس) :

در این حالت فصل مشترک جداکثر بی نظمی و جداکثر انرژی را خواهد داشت و دو فاز α و β هیچ گونه ارتباطی با هم ندارند در این حالت انرژی فصل مشترک $\frac{mj}{m^2} = 1000$ می باشد.

نکته: در این حالت اختلاف پارامتر شبکه بیش از ۲۵٪ است.

$$\chi = \chi_{ch} + \chi_{st} + \chi_{\text{تش}}$$

$$\delta = \frac{a_{\alpha} - a_{\beta}}{a_{\alpha}} \times 100$$

شکل رسوبات :

□ کاملا همدوس (کوهیرنت) : چنانچه رسوب ایجاد شده با زمینه شبکه‌ی کریستالی ساختار یکسانی داشته باشد و پارامتر شبکه‌ی آنها نیز اختلاف زیادی با یکدیگر نداشته باشند ($\delta < 25\%$) در این حالت فصل مشترک رسوب و زمینه کاملا همدوس خواهد بود در این حالت رسوب برای اینکه حداقل میزان انرژی فصل مشترک را داشته باشد به شکل کره در خواهد آمد چون کره کمترین میزان سطح به حجم را دارد

فصل مشترک همدوس – نیمه همدوس :

چنانچه رسوب و زمینه ساختارهای کریستالی مقاوتی داشته باشند ولی در بین آنها صفحه‌ای وجود داشته باشد که در آن صفحه کاملا بر هم منطبق می‌باشد در این حالت فصل مشترک رسوب و زمینه به صورت همدوس و نیمه همدوس و رسوب برای رسیدن به حداقل انرژی فصل مشترک شکل دیسک را به خود خواهد گرفت.



□ فصل مشترک کاملا ناهمدوس :

چنانچه رسوب و زمینه شبکه‌های کریستالی یکسانی نداشته باشند و صفحه‌ی مشترکی نیز بین آن دو وجود نداشته باشد که رسوب و زمینه در آن بر هم منطبق بشوند و اختلاف پارامتر شبکه‌ی زیاد باشد ($\delta > 25\%$ درصد) در این حالت فصل مشترک رسوب و زمینه ناهمدوس خواهد بود و رسوب برای رسیدن به حداقل انرژی شکل کره را به خود خواهد گرفت.

انواع استحالة‌ها (جامد – جامد یا solid – solid) :

- | | | | |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------|
| ۱) رسوب سختی | ۲) استحالة اسپینودال | ۳) استحالة توده ای | ۴) آلوتروپی |
| ۵) یوتکتوئید | ۶) تبلور مجدد | ۷) نظم و بی‌نظمی | |

رسوب سختی : precipitation hardening

هدف از این عمل افزایش سختی و استحکام از طریق ایجاد ذرات فاز ثانویه (رسوبات) ویژگی‌های سیستم‌های قابل رسوب سختی:

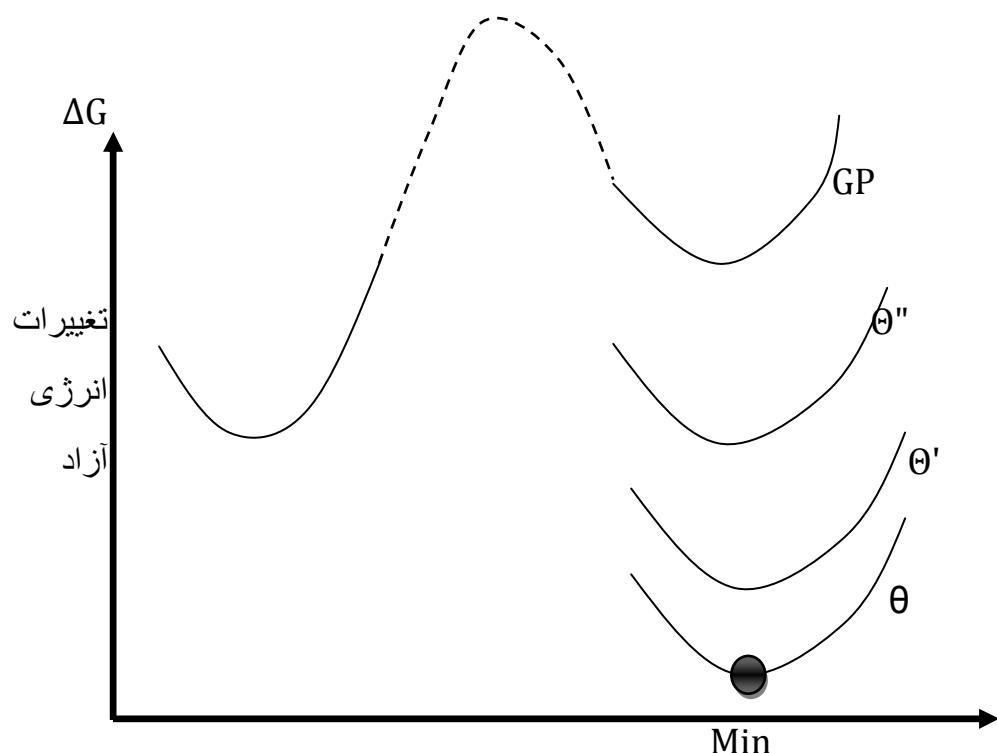
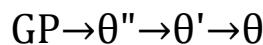
- ۱) حجم کافی رسوبات
- ۲) جزء آلیاژی (Al) در زمینه (Cu) حل شود (ناحیه تک فاز α (محول اشباع))
- ۳) با کاهش دما میزان حلایلت جزء آلیاژی در زمینه کم می‌شود (سریع سرد کردن محول فوق اشباع)
- ۴) اندازه رسوبات
- ۵) همدوس

مراحل ایجاد رسوبات :

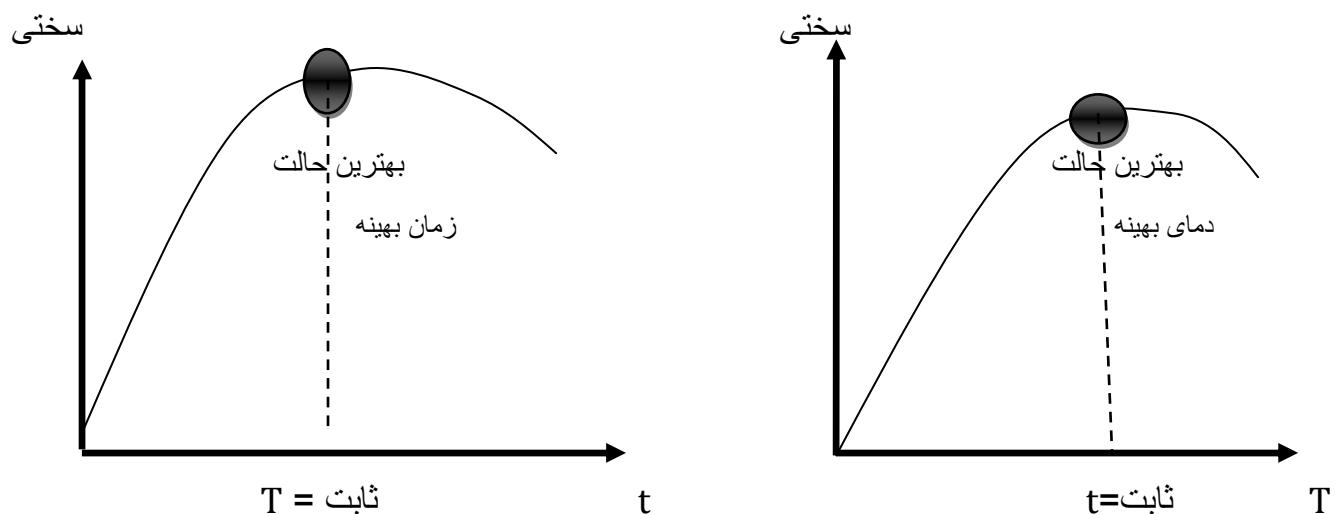
- ۱) محول جامد تک فاز
- ۲) سریع سرد کردن (محول جامد فوق اشباع)

(۳) پیر سازی : قرار دادن قطعه در دما و زمان مناسب جهت ایجاد رسوبات (فاز ثانویه) . پیر سازی به دو صورت مصنوعی و طبیعی انجام می‌ذیرد . (۴) سرد کردن تا دمای اتاق

انواع رسوبات در سیستم Al-Cu :

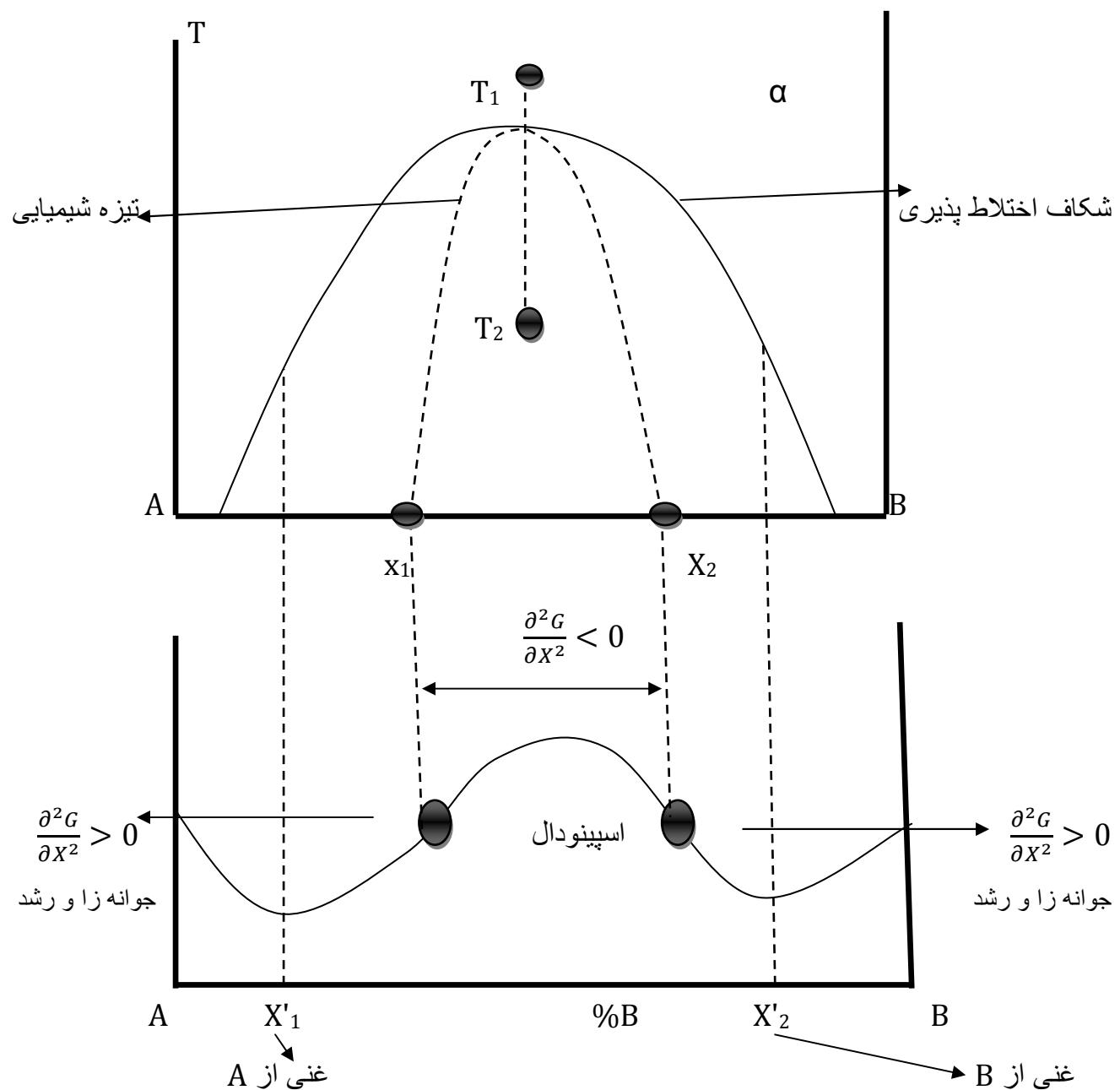
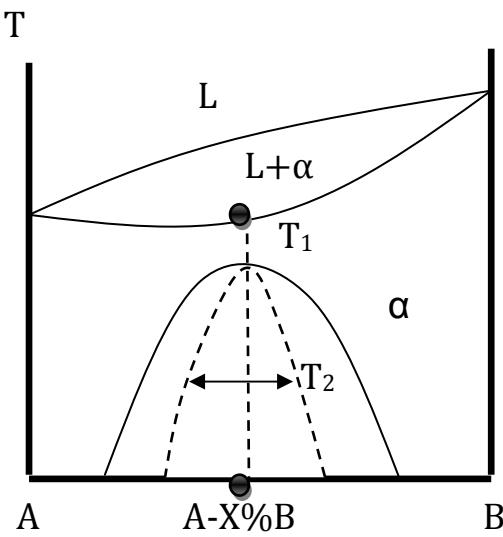


با توجه به نمودار بالا مشاهده می شود که انواع مختلفی از رسوبات در سیستم آلمینیوم- مس تشکیل می شود در بین این رسوبات تنها رسوب پایدار θ می باشد و مابقی شبیه پایدار هستند . علت : چون با توجه به شکل مشاهده می شود که سد انرژی فعال سازی برای فاز θ بیشترین مقدار است و فاز θ کمترین میزان انرژی را دارد و به همین دلیل پایدار ترین فاز می باشد در واقع علت تشکیل سایر فازها کم بون سد انرژی آنها نسبت به فاز θ است (در فرآندهای پیر سازی : دما و زمان بهینه را با توجه به نمودار های سختی بر حسب زمان و سختی بر حسب دما به دست می آوریم) :



استحالة اسپینودال (نفوذ سر بالا) :

جهت نفوذ را شبی غلطی مشخص نمی کند بلکه کاهش انرژی آزاد مشخص کننده ی نفوذ است .



در شکل صفحه‌ی قبلاً آمده با ترکیب $A-X\%B$ را در نظر بگیرید که در دمای T_1 قرار دارد (در این حالت آلیاژ دارای ساختاری همگن و تک فاز α است) اگر این آلیاژ را سریعاً سرد نماییم تا دمای T_2 در ابتدا آلیاژی

با ساختار همگن و تک فاز α خواهیم داشت ولی با گذشت زمان ترکیب شیمیایی آلیاژ تغییر خواهد کرد و آلیاژ تک فاز به دو دو فاز α_1 و α_2 تبدیل می شود ($\alpha \rightarrow \alpha_1 + \alpha_2$) که به ترتیب غنی از A و غنی از B هستند یعنی در طی این استحاله نفوذ از غلظت های زیاد انجام شده است که به آن نفوذ سر بالا می گویند این فرآیند تا جایی ادامه پیدا می کند که به حالت تعادل برسد یعنی دو فاز ' X_1 ' و ' X_2 ' به وجود می آیند با توجه به نمودار تغییر انرژی آزاد در دمای T_2 برای ترکیب شیمیایی $A-X\%B$ مشاهده می شود که :

حالت اول)

$$x_1 < X < x_2 \quad \frac{\partial^2 G}{\partial X^2} < 0 : \text{ تقریب } \downarrow$$

$$r^* = 0 \quad \Delta G^* = 0 \quad \text{سد انرژی فعالسازی = صفر}$$

$$\text{جوانه زنی نداریم} \quad \text{شعاع جوانه زنی = صفر}$$

حالت دوم)

استحاله از طریق نفوذ

$$\left\{ \begin{array}{l} X > x_2 \quad \frac{\partial^2 G}{\partial X^2} > 0 \\ X < x_1 \quad r^* \neq 0 \end{array} \right\} \rightarrow \text{و جوانه زنی رخ می دهد} \quad \text{و سد انرژی فعالسازی داریم}$$

تبیه شیمیایی در واقع مکان هندسی کلیه نقاط عطف منحنی های انرژی آزاد بر حسب ترکیب شیمیایی می باشد (در دماهای مختلف) مثلا آلیاژ Al-Ag از طریق استحاله اسپینودال رخ می دهد .

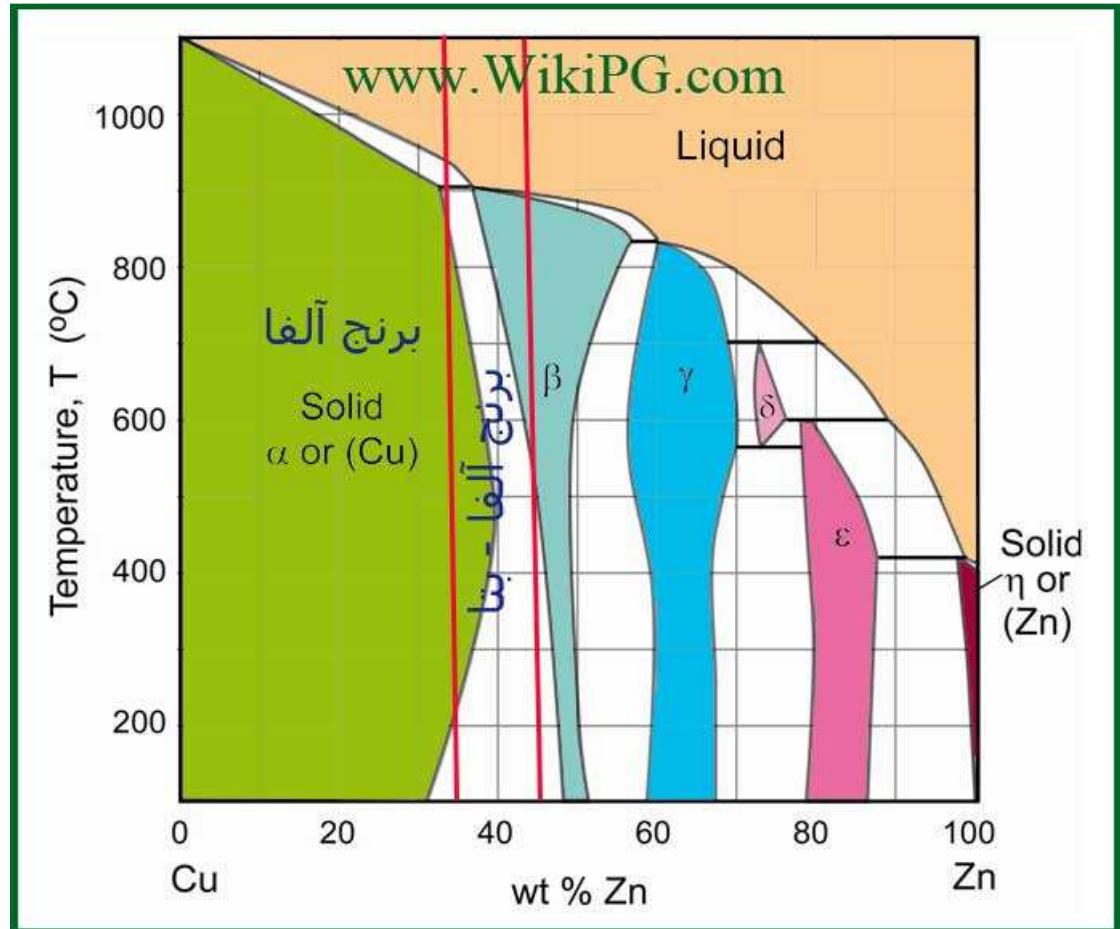
آلوتروپی :

به استحاله ای گفته می شود که در آن ترکیب شیمیایی ثابت است و فقط ساختار کریستالی تغییر می کند . در این استحاله نفوذ از نوع دامنه کوتاه است (چون ترکیب شیمیایی در این استحاله تغییر نمی کند) در چنین استحاله هایی دما نقش کمی دارد .

انواع نفوذ عبارت است از :

- ۱) نفوذ با دامنه کوتاه
- ۲) نفوذ با دامنه بلند

استحاله توده ای (massive) یا حجیم :



آلیاژ Cu-Zn زا با ترکیب تقریبی 38%Zn در نظر بگیرید در دماهای بالای 800°C فاز β و در زیر 500°C فاز α داریم و در بین این دو ترکیبی از $\alpha + \beta$ داریم . نوع استحالته ای انجام شده به سرعت سرد کردن بستگی دارد . در سرعت های آهسته (تعادلی) فاز α همانند استحالته ای یوتکنونید در دیاگرام آهن کربن از فاز β رسوب می کند و شکلی هم محور دارد با افزایش سرعت سرد کردن فاز α ایجاد شده سوزنی شکل می شود که به آن فریت ویدمن اشتاتن می گویند در هر دو حالت ذکر شده ترکیب شیمیایی تغییر می کند و نفوذ در دامنه ای بلند انجام می شود چنانچه آلیاژ فوق را با سرعتی سرد نماییم که امکان نفوذ و تغییر ترکیب شیمیایی فراهم نشود α ای خواهیم داشت با همان ترکیب اولیه ای β که به چنین استحالته ای massive یا حجیم یا توده ای می گویند یعنی استحالته ای بدون نفوذ و جابجایی اتم ها

قوانين تبلور مجدد :

۱) دمای تبلور مجدد با زمان آن رابطه ای معکوس دارد . ولی پارامتر دما بسیار مهم تر از زمان است چون اگر دما از یک حد بحرانی کمتر شود حتی در زمان های بسیار طولانی هم تبلور مجدد رخ نخواهد داد.

۲) دمای تبلور مجدد و کار سرد با هم رابطه ای معکوس دارند ولی این مسئله به این مفهوم نیست که بتوانیم میزان کار سرد را تا هر مقدار دلخواه کاهش دهیم برای کار سرد یک میزان بحرانی وجود دارد برابر با حدود 5%

۳) راه های کاهش اندازه دانه در تبلور دانه :

الف) کار سرد بیشتر

ب) با افزایش سرعت گرم کردن

ج) با انتخاب فلز دانه ریزتر از همان ابتدا

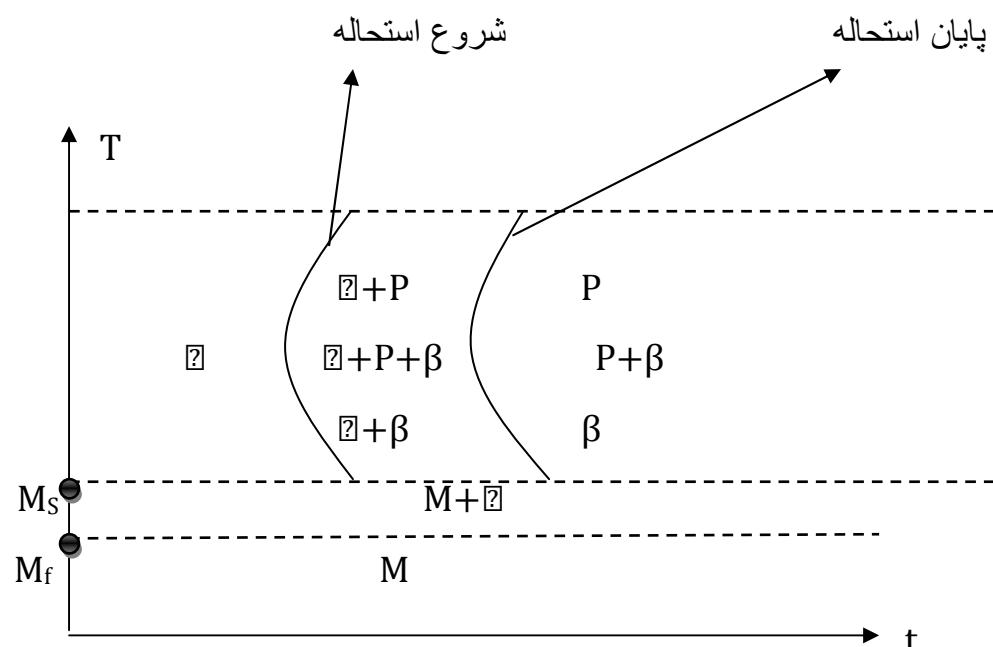
د) با انتخاب دمای تبلور مجدد کمتر

استحاله نظم و بی نظمی :

به استحاله ای گفته می شود که در آن نه ترکیب شیمیایی تغییر می کند نه ساختار کریستالی فقط منظم و مرتب تر می شود .

Time Temprature Transformation : TTT

$$\begin{cases} I T & \text{هم دما} \\ C T & \text{پیوسته} \end{cases}$$



منابع :

Phase transformation in metals and alloys D.A.PORTER

استحالة فازها در فلزات و آلیاژها ترجمه‌ی محمدرضا افضلی از دانشگاه تهران

Diffusion in solid P.shewman

□ مبانی متالورژی فیزیکی و علم مواد اثر دکتر عباس هنر بخش رئوف ، مهندس حجت‌الله شهسواری ،
مهندس ابوالفضل زارع ، انتشارات جهاد دانشگاهی